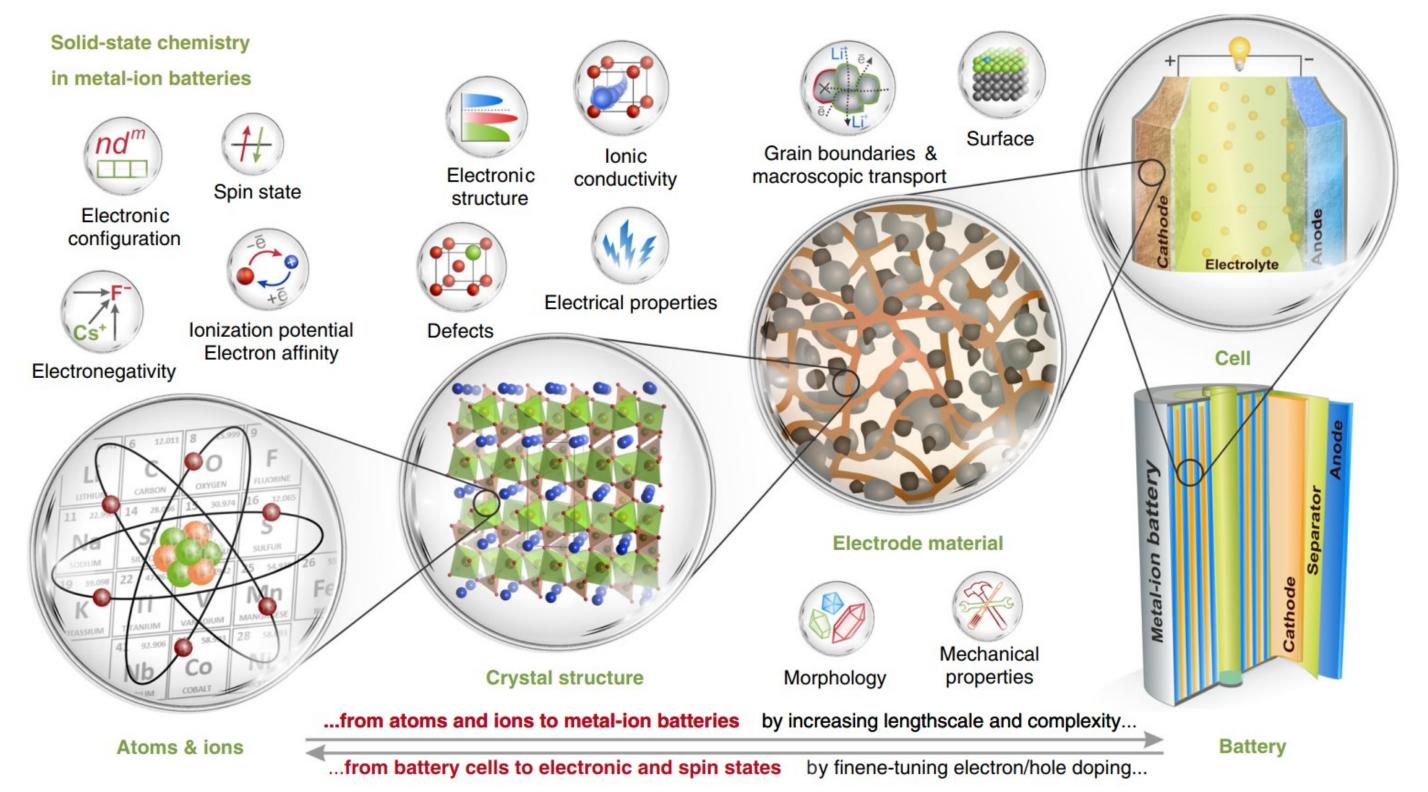
Dr. Anatolii V. Morozov

Physicochemical characterization techniques for electrode materials

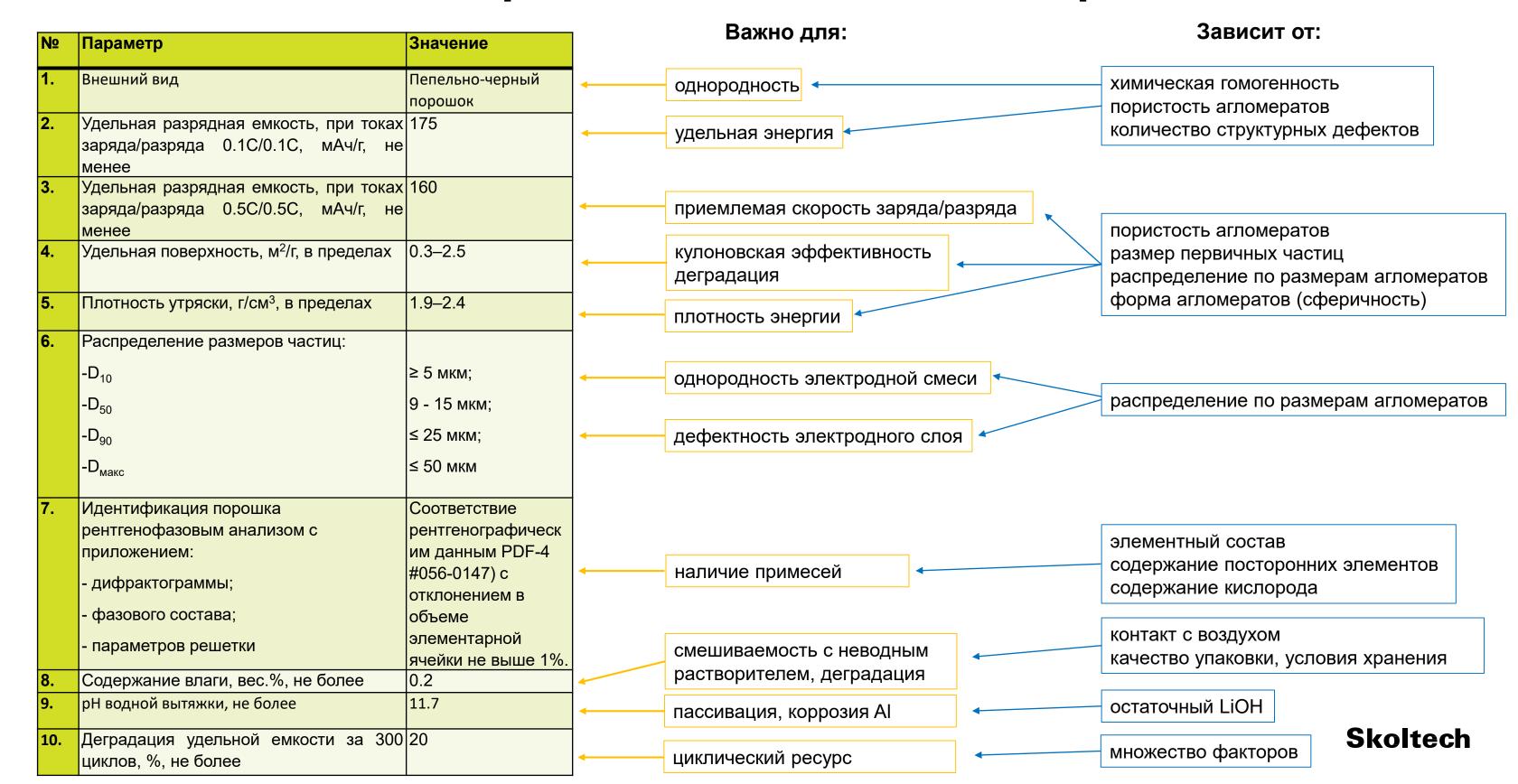
Skolkovo Institute of Science and Technology CEST

Moscow 18 November, 2024

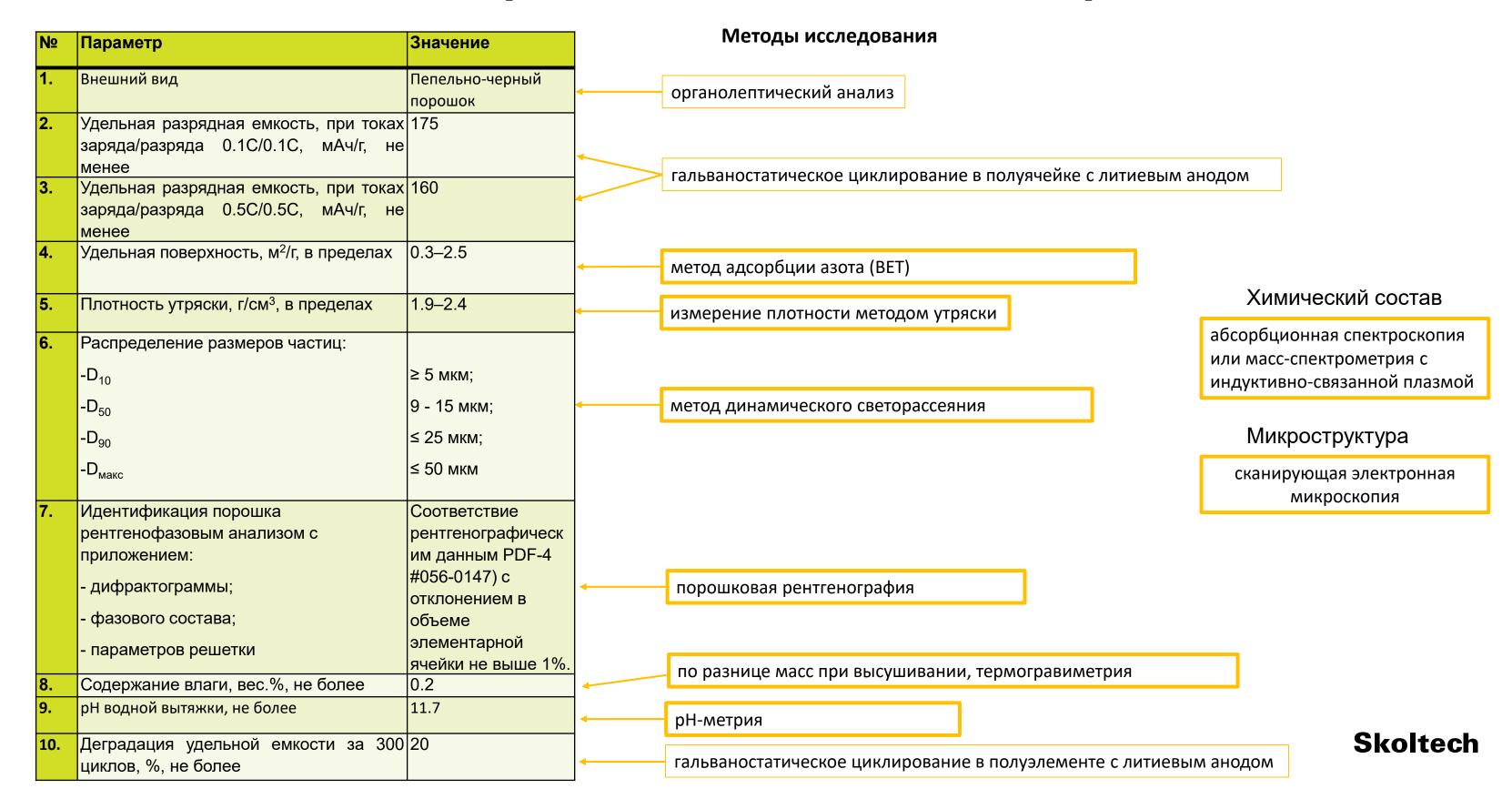
Твердотельные литий-ионные аккумуляторы (ТЛИА)



Техническая спецификация катодного материала NMC622

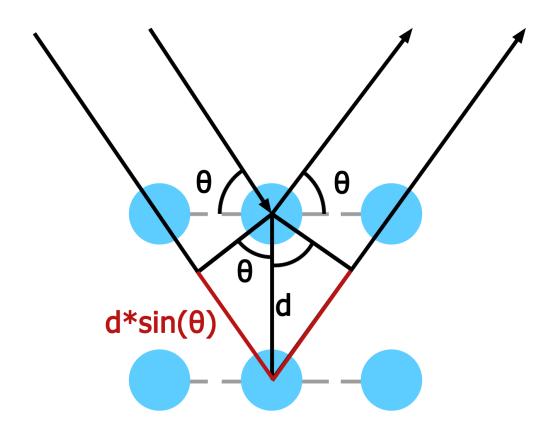


Техническая спецификация катодного материала NMC622



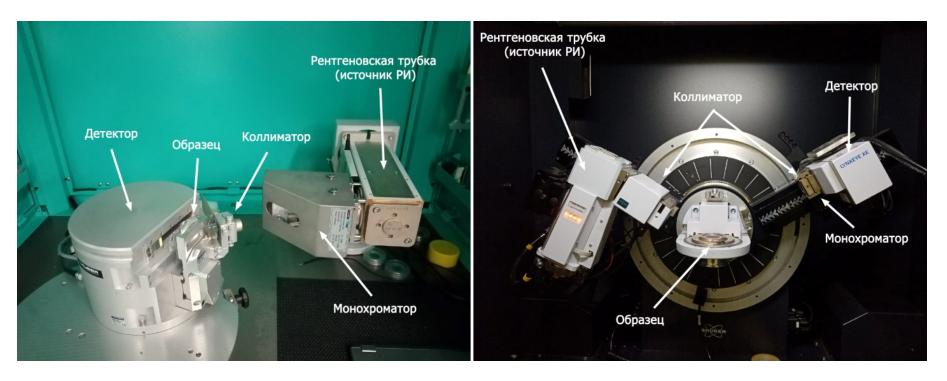
4

Порошковая рентгеновская дифракция (PXRD)



$$2d \sin \theta = n\lambda, (n = 1, 2, ...)$$

Уравнение Брэгга-Вульфа

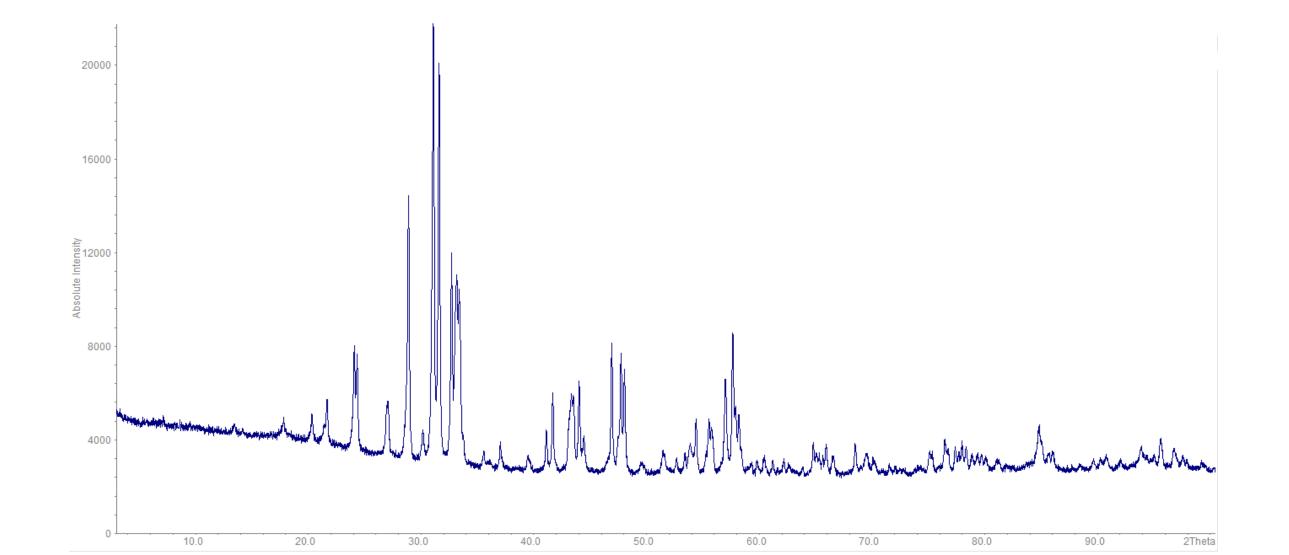


Дифрактометры Huber G670 (слева) и Bruker D8 Advanced (справа) с различной геометрией взаимного расположения узлов

Порошковая рентгеновская дифракция (PXRD)

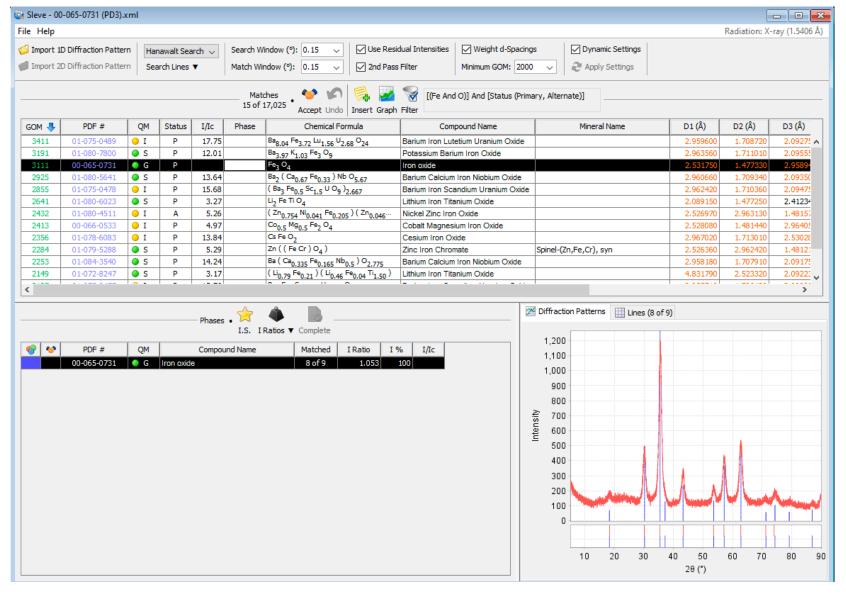
- Фазовый состав
- Кристаллографическая информация (параметры ячейки, концентрация дефектов и т.д.)

Качественный рентгенофазовый анализ (РФА) – процесс детектирования присутствия в смеси тех или иных соединений (фаз), без определения их количественного содержания.

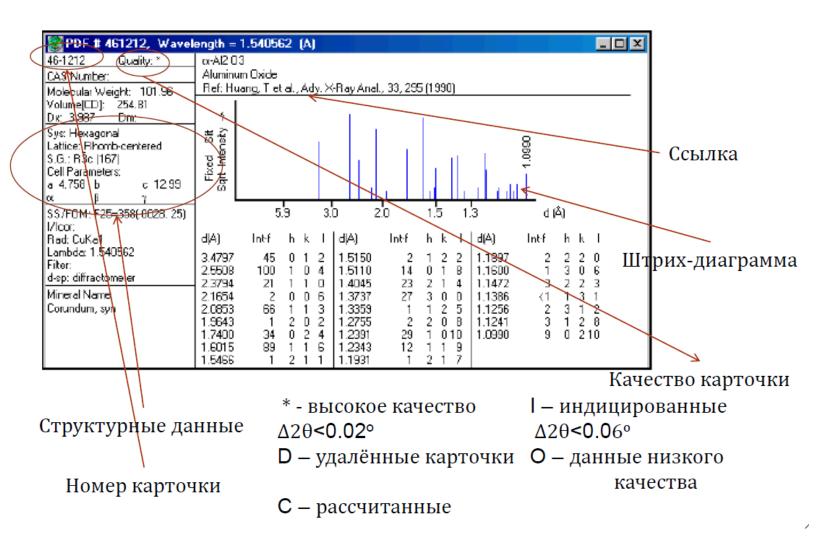


Фазовый состав. База данных ICDD.

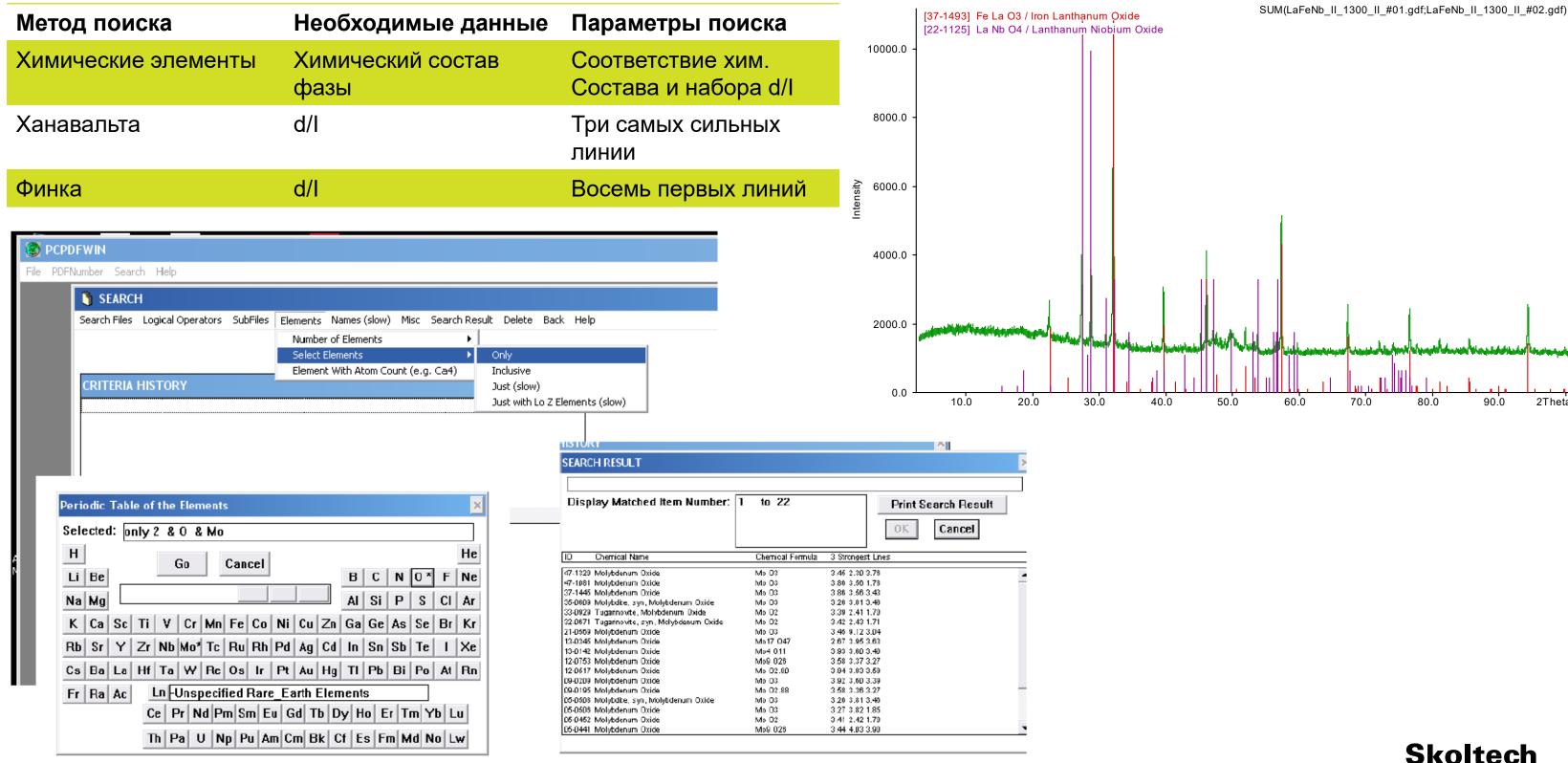




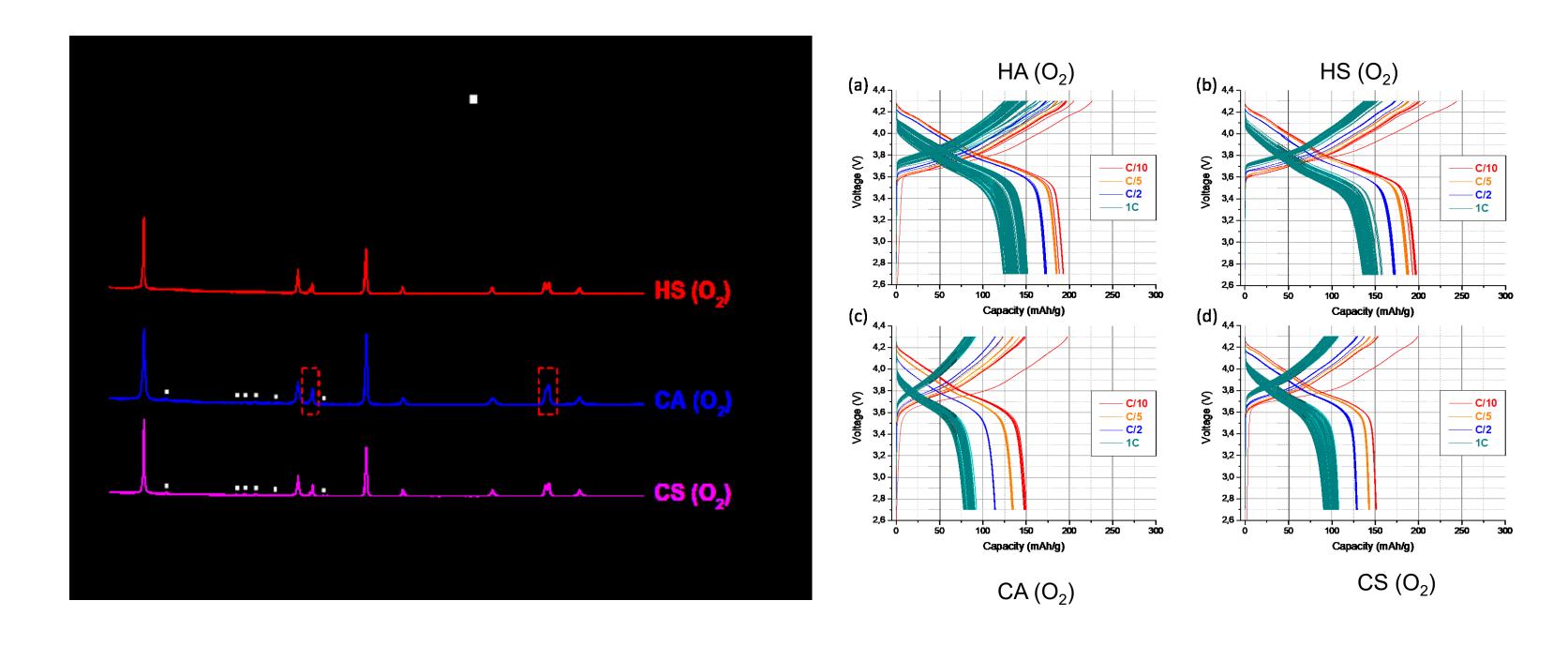
международная базы данных (БД) дифракционных стандартов (выпускается компанией ICDD - International Center for Diffraction Data) - базы данных PDF-2 (Powder Diffraction File - 2)



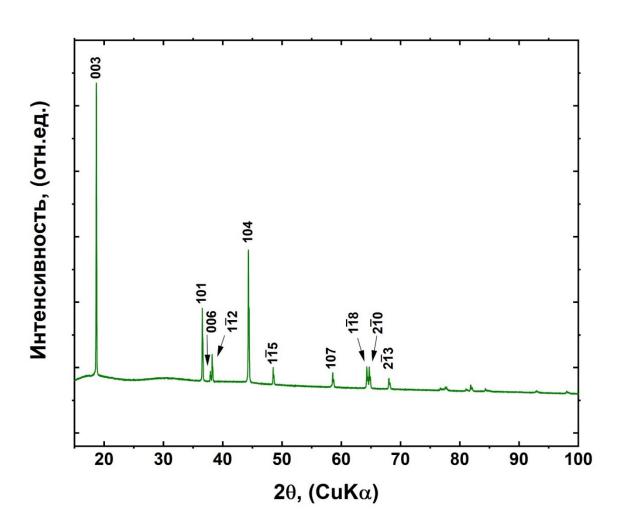
Методы качественного фазового анализа



Почему это важно?



Кристаллографическая информация о соединении (индицирование)



$$a = b \neq c$$
, $\alpha = \beta = 90^{\circ} \text{ y} = 120^{\circ}$

Методы индицирования рентгенограмм

- 1. Аналитические (вручную)
- 2. Подбор изоструктурного соединения
- 3. Автоиндицирование (программы)
- 4. Метод гомологии

$$2d \sin \theta = n\lambda, (n = 1, 2, ...)$$

Связь d и параметров элементарной ячейки

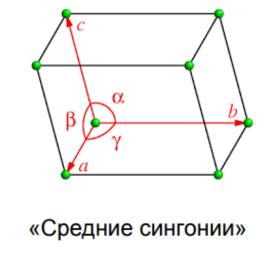
Общее выражение для *d* (т.е. для триклинной сингонии):

$$\frac{1}{d^2} = \frac{\frac{h^2}{a^2 \sin^2 \alpha} + \frac{2kl}{bc} (\cos \beta \cos \gamma - \cos \alpha) + \frac{k^2}{b^2 \sin^2 \beta} + \frac{2kl}{ac} (\cos \alpha \cos \gamma - \cos \beta) + \frac{l^2}{c^2 \sin^2 \gamma} + \frac{2kk}{ab} (\cos \alpha \cos \beta - \cos \gamma)}{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$$

Несколько проще для высших сингоний

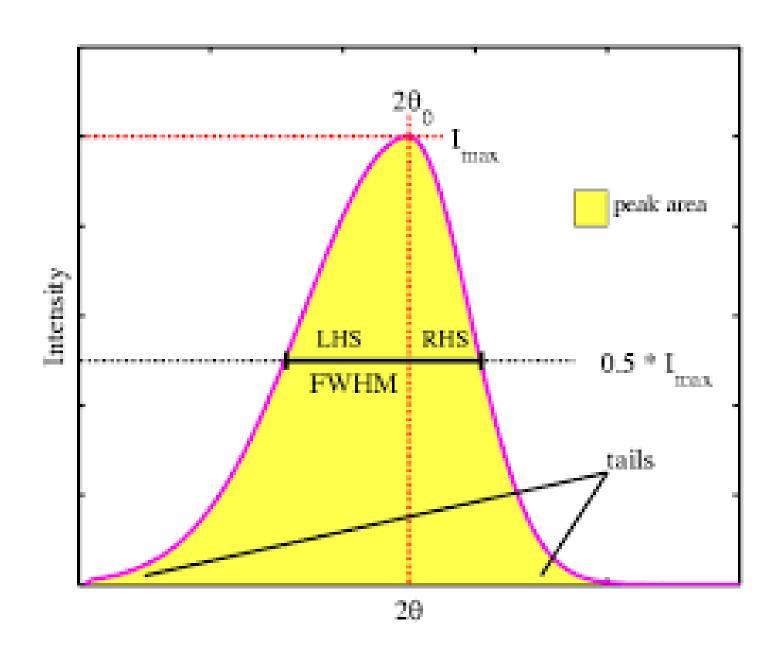
$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$
 Кубическая
$$\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \frac{h^2 + k^2 + hk}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
 Гексагональная
$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
 Тетрагональная

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
 (Орто)ромбическая



$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2 \sin^2 \beta} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2 \sin^2 \beta} + \frac{2hl \cos \beta}{ac \sin^2 \beta}$$
 Моноклинн

Параметры дифракционного максимума



- 1) Положение «центра масс»
- 2) Интегральная интенсивность

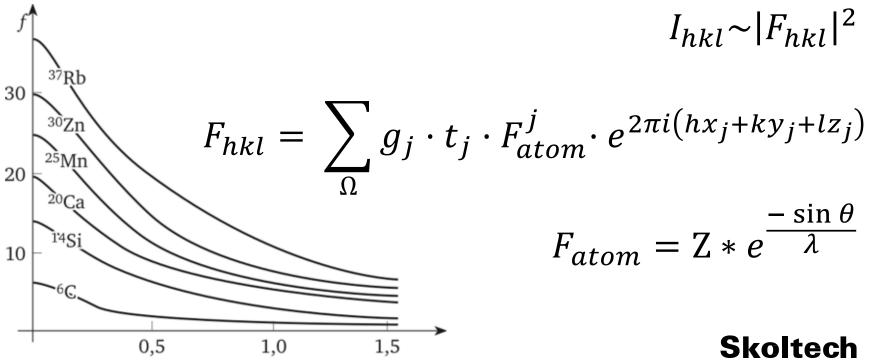
$$2d \sin \theta = n\lambda, (n = 1, 2, ...)$$

1 зависит от: d, то есть сингонии и параметров элементарной ячейки

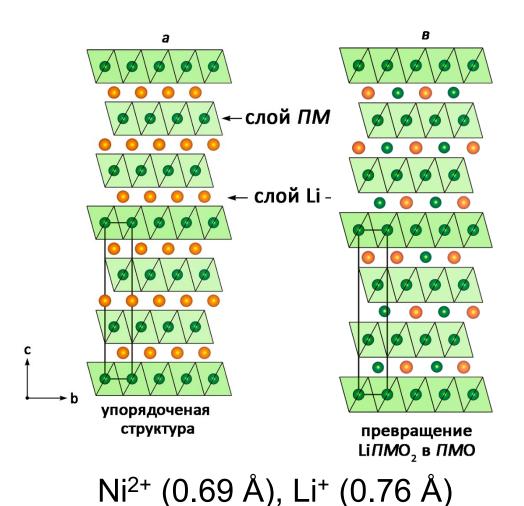
2 зависит от:

- Химической природы атомов
- Мотива их расположения в элементарной ячейке

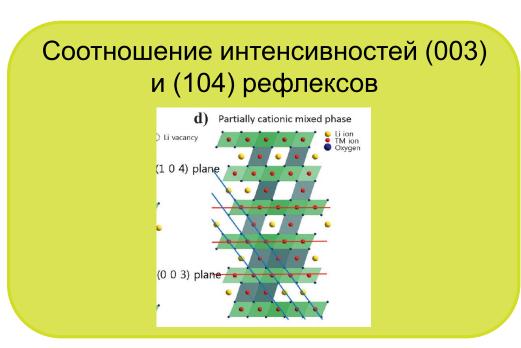
 $(\sin\theta)/\lambda$

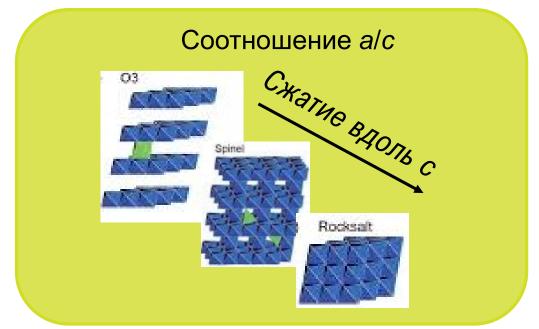


Анализ дефектной структуры

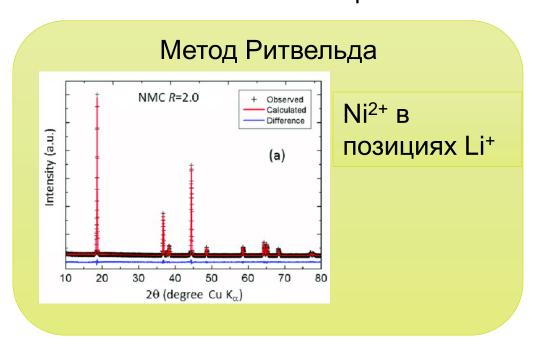


Полуколичественная оценка

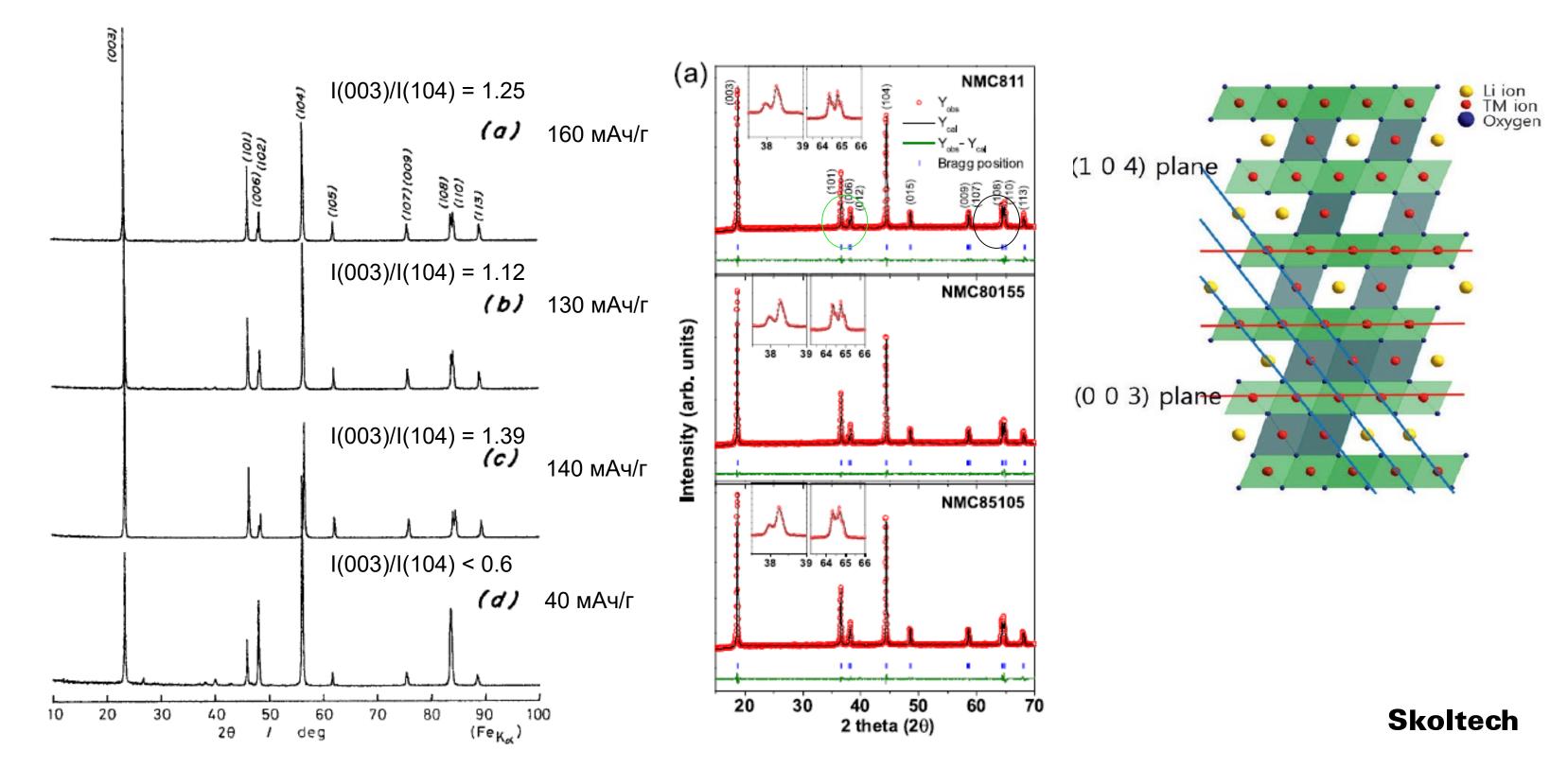




Количественная оценка



Анализ дефектной структуры. Полуколичественная оценка.



Анализ дефектной структуры. Количественная оценка методом Ритвельда.

Table A1. Rietveld refinement parameters and figures of merit

Sample	Conditions		Dhasas	- 8	. 8	1:0 8	TMO	7-	U _{iso} , 10-	Ni in Li	Li in Ni	GOF,	Rp,	wRp,
	XRD source/λ, Å	2θ	- Phases	a, Å	c, Å	Li-O, Å	TM-O, Å	Zo	² Å ² .	sites, %	sites, %	%	%	%
HA	Cu/1.540	10-90	Layered	2.8748(1)	14.2131(8)	2.0810(6)	1.9986(8)	0.24500(9)	0.2713(1)	5.95	4.34	1.39	2.09	2.74
HS	Co/1.789	4-100	Layered	2.8792(6)	14.2308(1)	2.1246(0)	1.9655(0)	0.24036(1)	0.491(2)	4.63	4.86	1.90	2.24	3.21
CA	Cu/1.540		Layered	2.8759(3)	14.2165(3)	2.0862(9)	1.9951(6)	0.24447(9)	0.3146(1)	6.92	3.93	1.47	2.43	3.20
CS	Cu/1.540	10-90	Layered	2.8776(4)	14.2213(3)	2.1040(5)	1.9811(5)	0.24255(3)	0.1943(4)	6.34	1.94	1.38	2.13	2.78
HA (O ₂)	Co/1.789	4-100	Layered	2.8700(9)	14.1987(9)	2.1266(3)	1.9529(5)	0.23945(5)	0.9817(7)	1.82	10.08	1.28	1.89	2.58
HS (O ₂)	Co/1.789	4-100	Layered	2.8733(5)	14.2088(2)	2.1244(5)	1.9685(1)	0.23993(5)	0.0728(5)	2.5	5.6	1.27	2.29	2.96
CA (O ₂)	Co/1.789	4-100	Layered+ Li ₂ CO ₃	2.8738(8)	14.1726(4)	2.1261(9)	1.9533(8)	0.23946(3)	1.1001(4)	5.09	13.03	2.67	3.38	5.02
CS (O ₂)	Co/1.789	4-100	Layered+ Li ₂ CO ₃	2.8722(6)	14.1893(9)	2.1276(6)	1.9532(6)	0.23939(1)	0.1105(4)	4.12	7.9	2.21	2.82	4.23
HS-10.5	Cu/1.540	10-90	Layered	2.8767(1)	14.2167(3)	2.0929(3)	1.9899(1)	0.24437(9)	1.4002(9)	6.27	9.12	1.36	2.64	3.49
HS-11	Cu/1.540	10-90	Layered	2.8765(8)	14.2152(3)	2.0924(2)	1.9900(4)	0.24379(3)	0.2454(0)	5.86	2.21	1.21	2.43	3.10
HS-11.5	Co/1.789	4-100	Layered	2.8782(9)	14.2271(4)	2.1245(1)	1.9644(1)	0.24029(7)	0.1017(1)	4.19	3.37	1.44	2.04	2.86
HS-10.5 (O ₂)	Cu/1.540	10-90	Layered	2.8708(8)	14.1973(6)	2.0961(5)	1.9799(8)	0.24295(2)	0.1801(5)	3.21	4.53	1.44	2.73	3.63
HS-11 (O ₂)	Cu/1.540	10-90	Layered	2.8711(9)	14.2039(5)	2.0938(5)	1.9829(1)	0.24327(5)	0.2439(4)	2.71	5.68	1.19	2.71	3.46
HS-11.5 (O ₂)	Co/1.789	4-100	Layered	2.8740(7)	14.2103(2)	2.1243(0)	1.9593(9)	0.23999(5)	0.0811(7)	2.67	5.73	1.51	2.08	2.85

ОКР и микронапряжения. Построение Уильямсона-Холла.

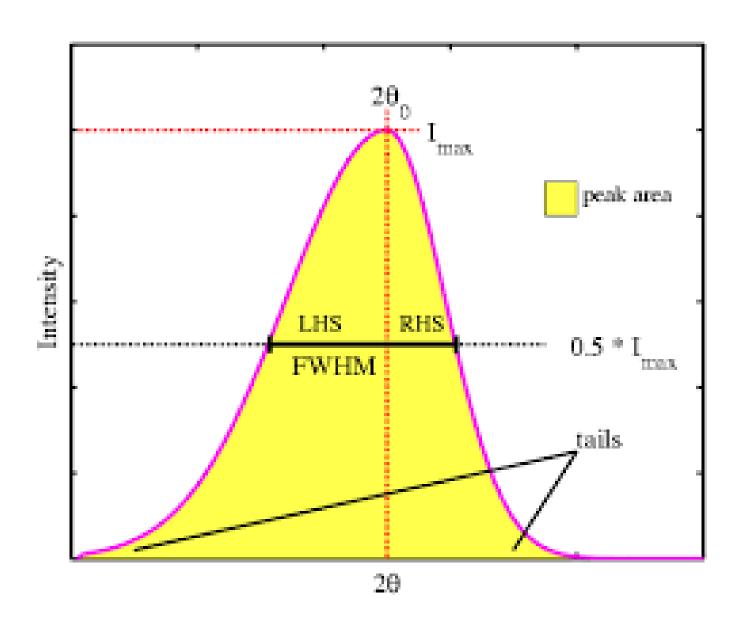
0.02

0.01

0.1

0.2

0.3



К — константа Шеррера

 λ — длина волны используемого излучения

 β — интегральная ширина пика (в радианах)

 θ — дифракционный угол

$$\beta = \frac{K\lambda}{D\cos\theta} \qquad \beta = 4\left\langle\frac{\Delta d}{d}\right\rangle \tan\theta$$

$$\beta = \frac{K\lambda}{D\cos\theta} + 4\left\langle\frac{\Delta d}{d}\right\rangle \tan\theta$$

$$\beta \cos\theta = \frac{K\lambda}{D} + 4\left\langle\frac{\Delta d}{d}\right\rangle \sin\theta$$

0.4

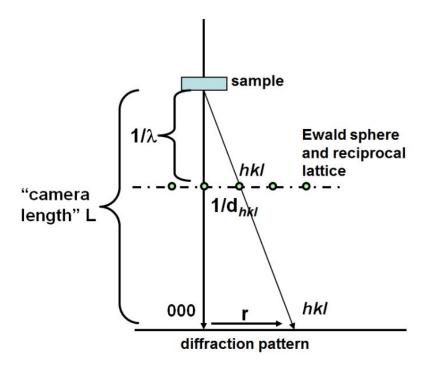
Электронная дифракция

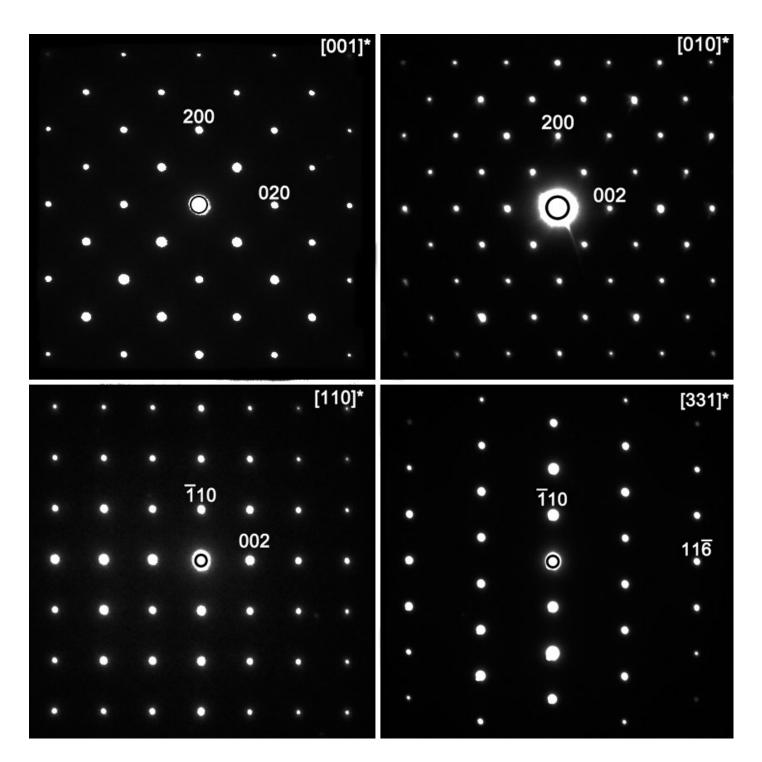
Уравнение Брэгга-Вульфа для дифракции электронов

$$2d_{hkl}\sin\theta=\lambda$$
, $heta$ — мал

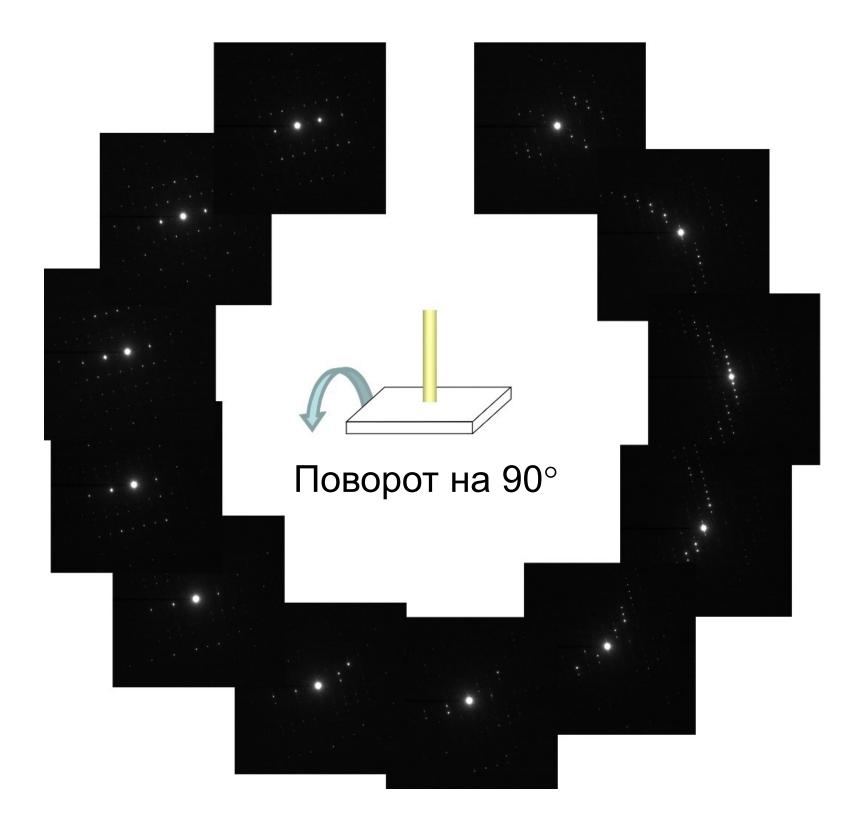
$$\sin \theta \approx \theta$$

$$d_{hkl} \approx \frac{\lambda}{2\theta} \approx \frac{\lambda}{\tan(2\theta)} = \frac{L\lambda}{r}$$

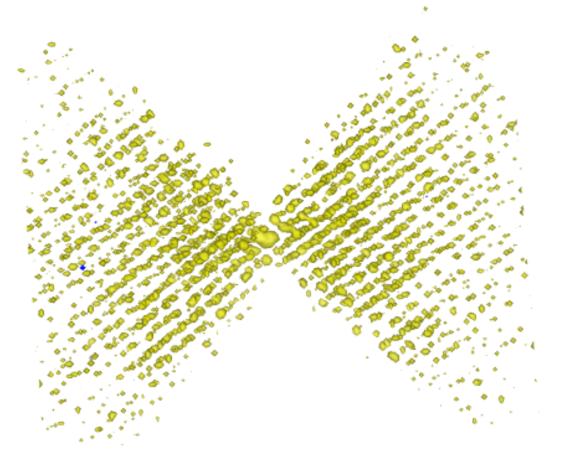




Томография обратного пространства



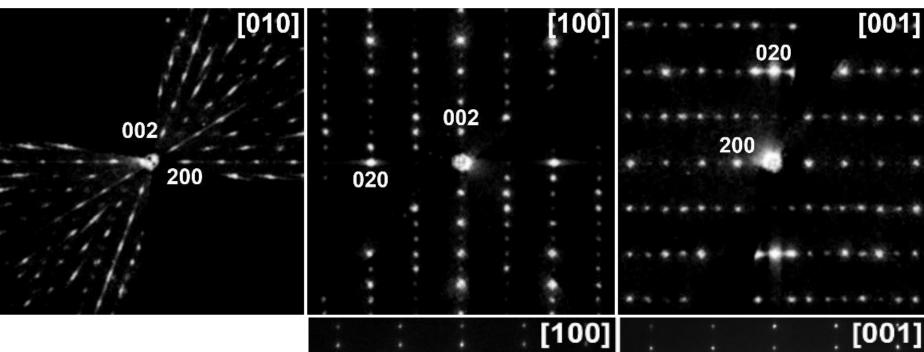
- 1. Регистрация дифракционных картин каждые 0.5-1°
- 2. Обработка данных, интегрирование интенсивностей в квази-кинематическом приближении
- 3. Реконструкция 3D обратного пространства
- 4. Поиск структурной модели



Томография обратного пространства

Данные, полученные из эксперимента по томографии обратного пространства

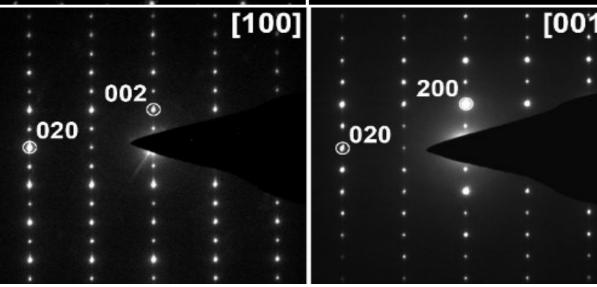




Электронная дифракция



Невозможно получить экспериментально



30kV X2,700 5μm 0158 11 60 SEI

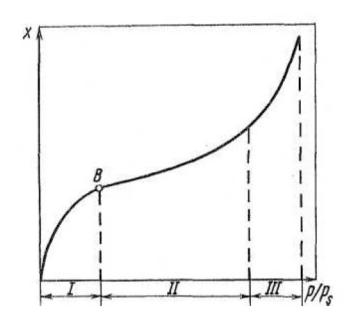
Na₅Ni₂(PO₄)₃·H₂O, S.G. $P2_1/n$, a = 14.039 Å, b = 5.185 Å, c = 16.474 Å, $\beta = 110.42^\circ$

Удельная площадь поверхности

Удельная поверхность твердых тел: $S_{\Sigma} = \left(x_m \frac{N_A}{q}\right) \chi$

 x_m - количество адсорбированного вещества, содержащегося в монослое на поверхности; N_A - число Авагадро; q — навеска порошка; χ — площадь, занимаемая одной молекулой газа, адсорбированного в монослое ($\chi(N_2)$ = 16.2 Å).

• По точке перегиба изотермы адсорбции



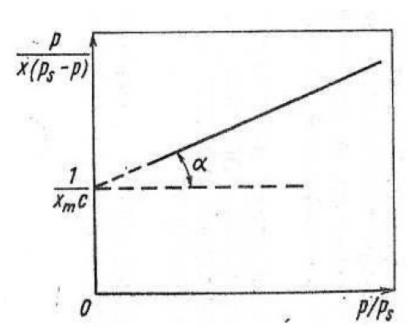
Зависимость количества адсорбированного газа (пара) х от относительного давления р/р_s адсорбата

• По методу Брунауэра-Эммета-Теллера (методу БЭТ)

Уравнение полислойной адсорбции:

$$\frac{p}{x(p_s - p)} = \frac{1}{x_m \cdot c} + \frac{c - 1}{x_m \cdot c} \cdot \frac{p}{p_s}$$

 p_s - давление насыщенных паров адсорбата над плоской поверхностью, c - постоянная, зависящая от рода газа и качества твердой поверхности.



Графическое решение уравнения адсорбции БЭТ

Предел измерений: $0.01...500 \text{ м}^2/\text{г}$, Погрешность: $\pm (5...10) \%$ (p/p_s = 0.05-0.35)

Определение насыпной плотности и плотности утряски

Насыпная плотность порошкового материала – величина массы порошка, приходящейся на единицу объема при свободной его засыпке.

Плотность утряски характеризуется способностью порошка к структурному уплотнению без деформации частиц при механическом вибровстряхивании, когда частицы наиболее компактно перераспределяются в занимаемом объеме.

Зависят от формы частиц и фракционного состава порошка



Волюмометр

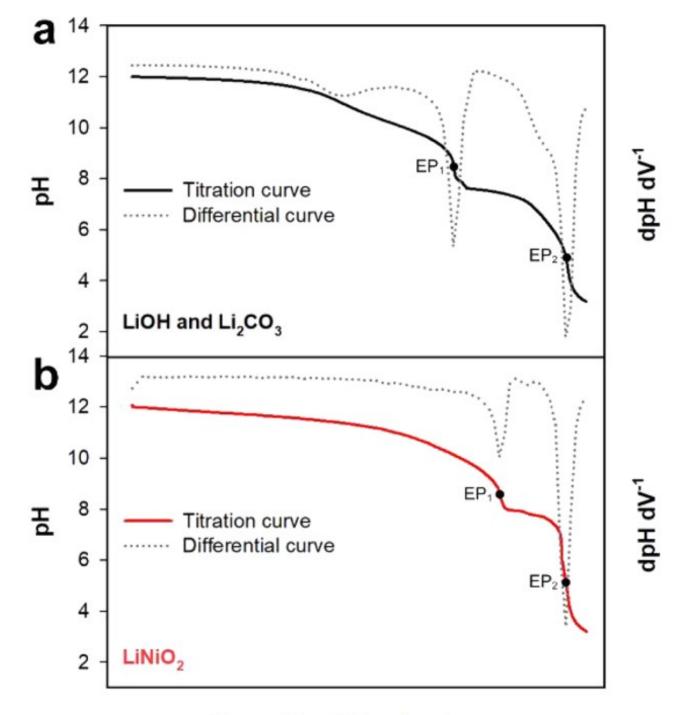


Тестер для определения плотности утряски (Tap density tester)

рН водной вытяжки (определение остаточного LiOH)



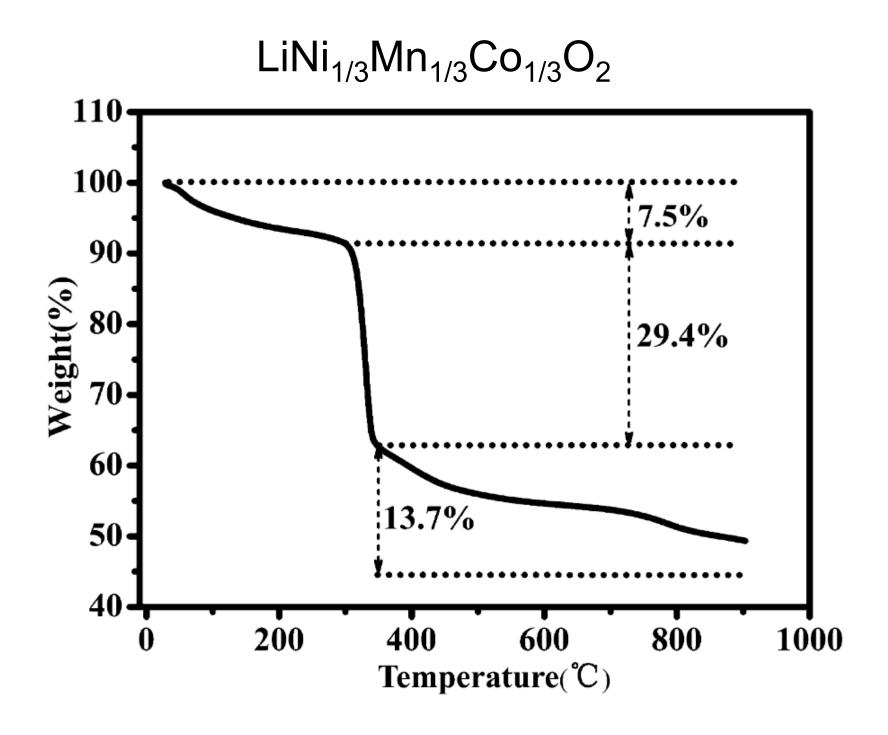
LiOH + HCl \rightarrow LiCl + H₂O Li₂CO₃ + HCl \rightarrow LiHCO₃ + LiCl LiHCO₃ + HCl \rightarrow LiCl + CO₂ + H₂O



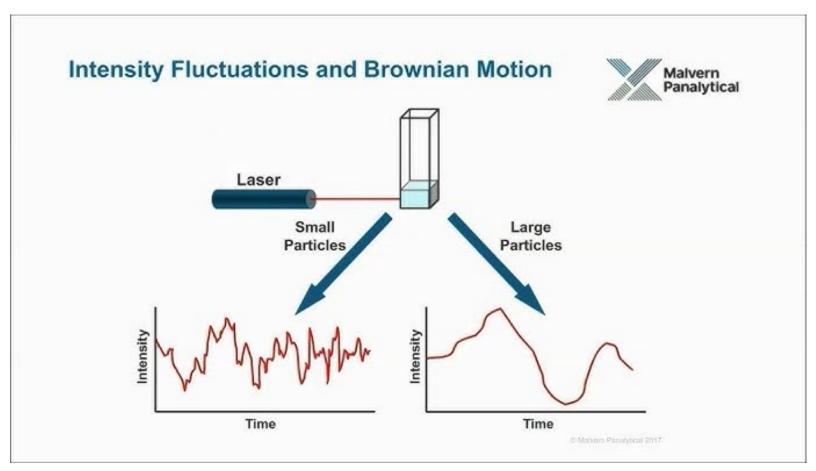
Normalized titrant volume

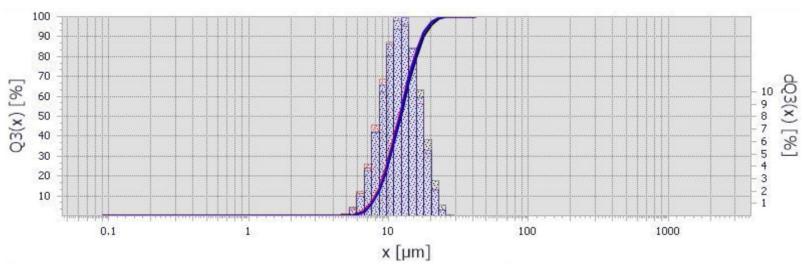
Термогравиметрия (пределение остаточной H₂O)





Распределение частиц по размерам (DLS)





Уравнение Стокса-Эйнштейна

$$D = \frac{k_B T}{6\pi \eta R_H}$$

D – коэффициент диффузии
 («скорость частиц») [м²/с]
 К_В – постоянная Больцмана [Дж/К]

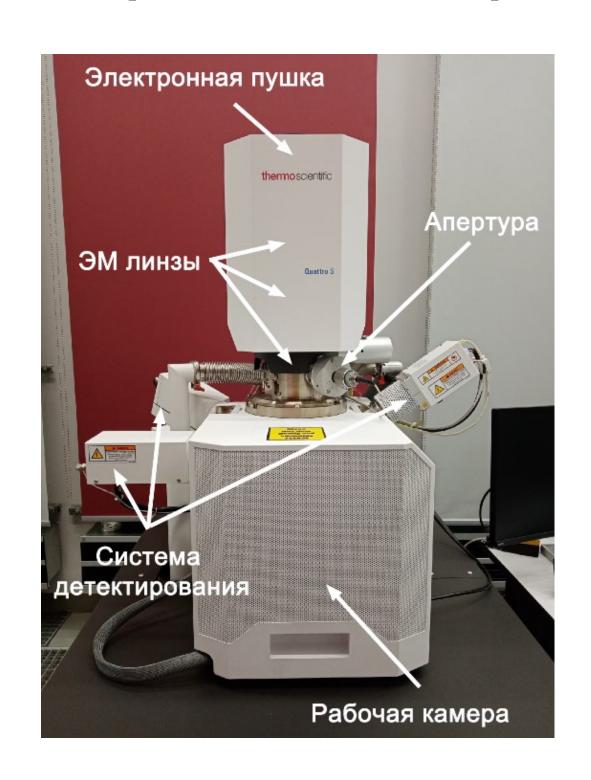
T – температура [K]

η – вязкость растворителя [Па·с]

R_H – Гидродинамический радиус [м]

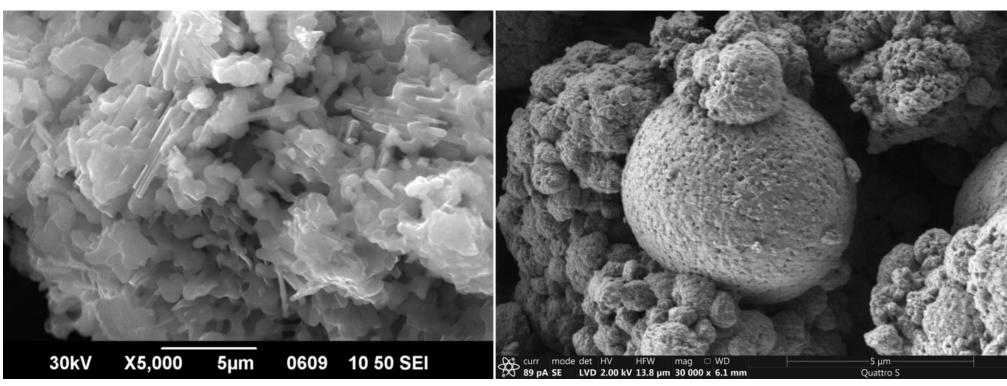
- + Быстро, просто, «дёшево»
- «Сферические» частицы
- Контакт с жидкостью
- Агломерация частиц

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Режим вторичных электронов и морфология



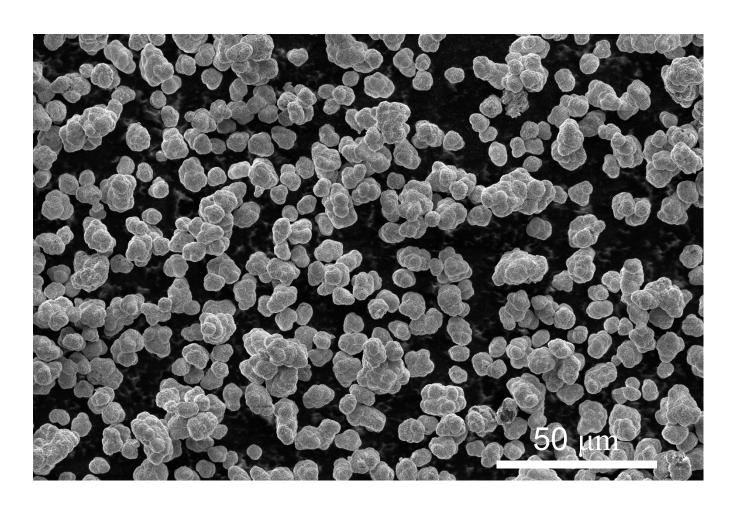
Что влияет на выход вторичных электронов?

- Работа выхода
- Химическая плотность
- Интенсивность первичного пучка
- Топография поверхности



Skoltech

Распределение частиц по размерам (СЭМ)



RESEARCH AF

DLgram c images



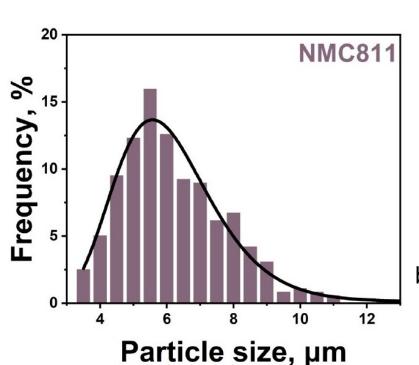
Nanoparticles

563 участника

MICROSCOPY ARCH&TECHNIQUE WILEY

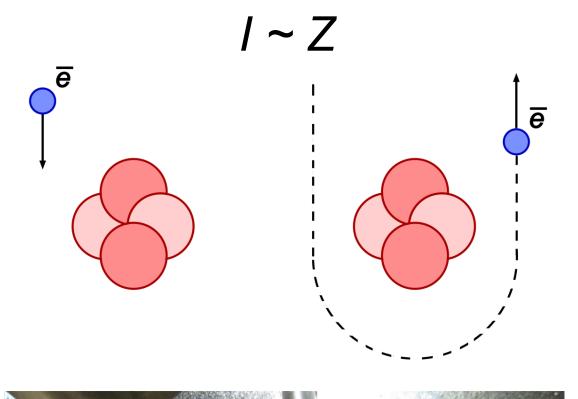
of microscopy

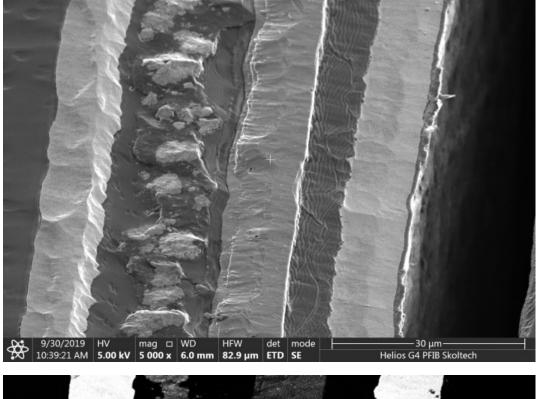




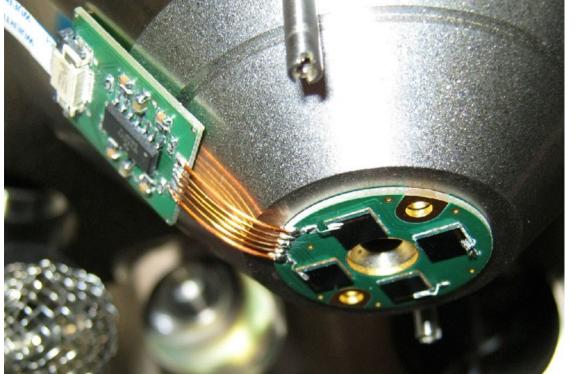
by N.B. Timusheva

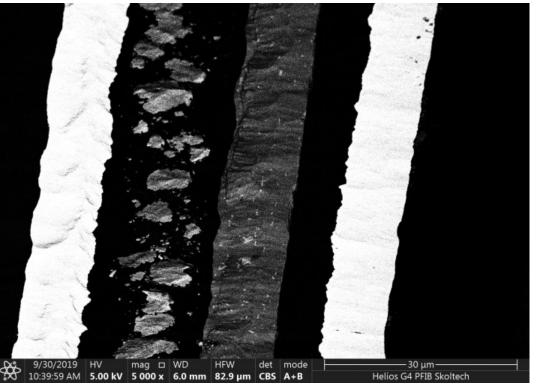
СЭМ, режим обратно рассеянных электронов





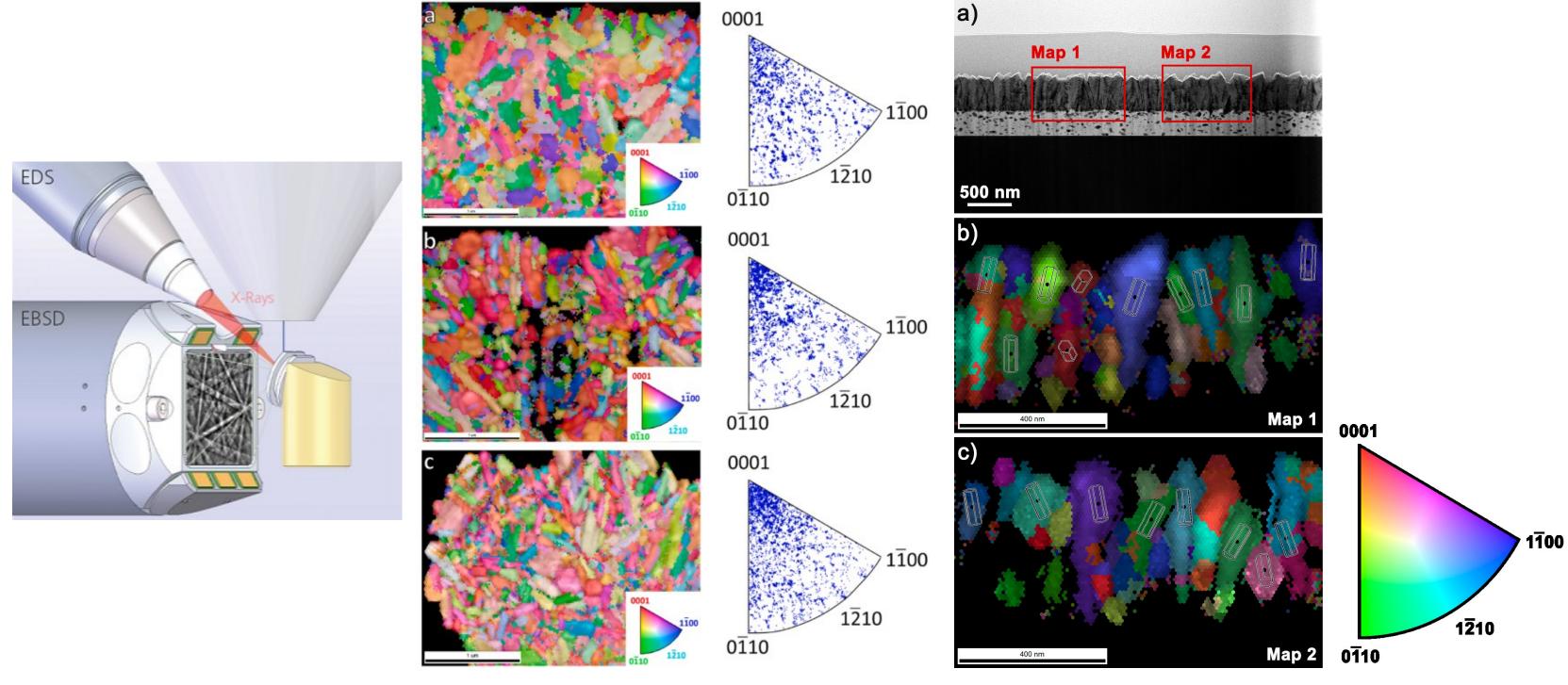
Вторичные е





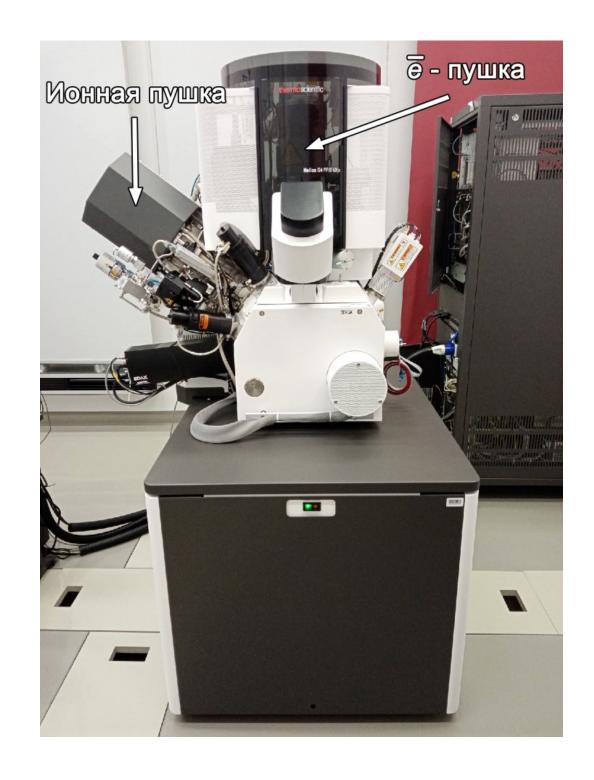
Обратно рассеянные *е*

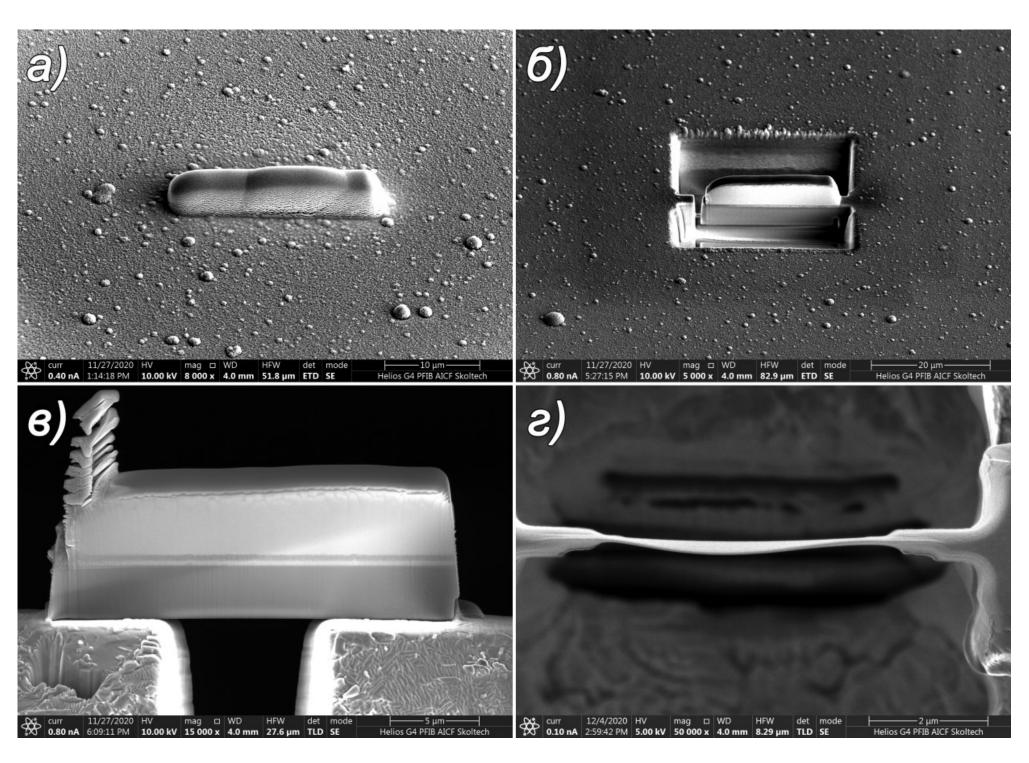
Дифракция обратно рассеянных электронов (ДОРЭ)



I.A. Skvortsova et al., Journal of Power Sources 583 (2023) 233571 A.V. Morozov et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 39907–39916

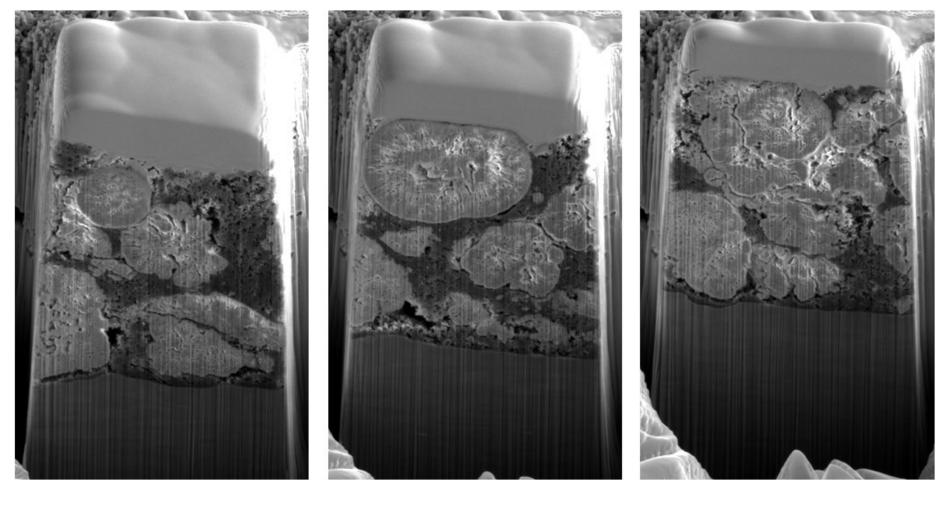
СЭМ с системой сфокусированного ионного пучка



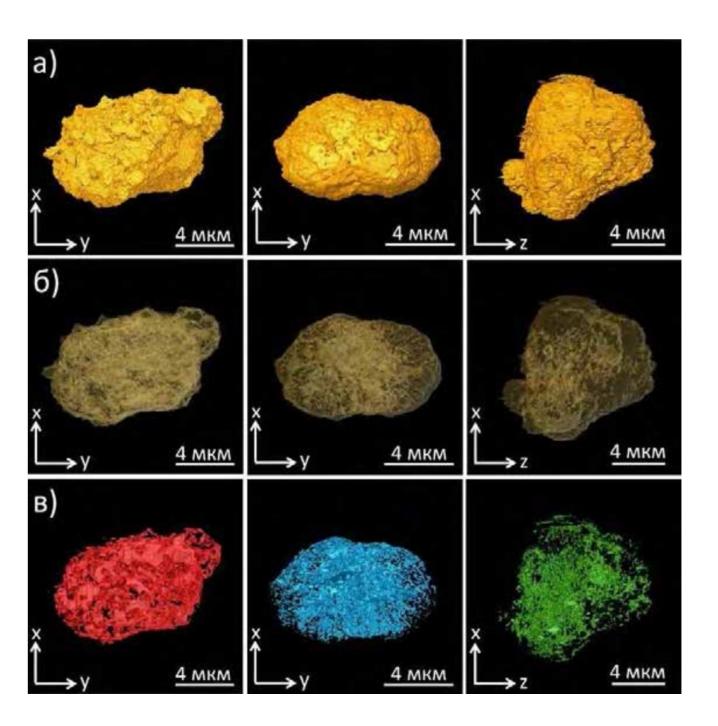


Skoltech

Slice&View



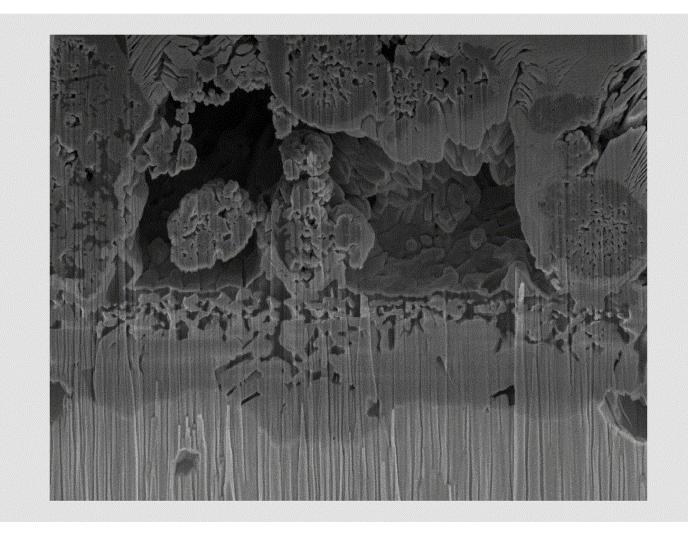
СЭМ-изображения трёх срезов аккумуляторной катодной пасты, полученные на разных этапах эксперимента с использованием технологии Slice&View

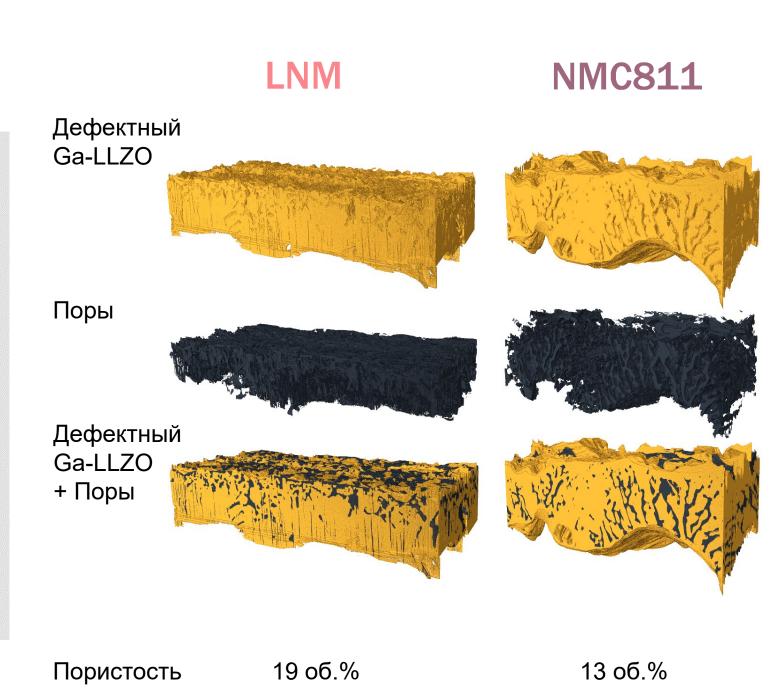


Skoltech

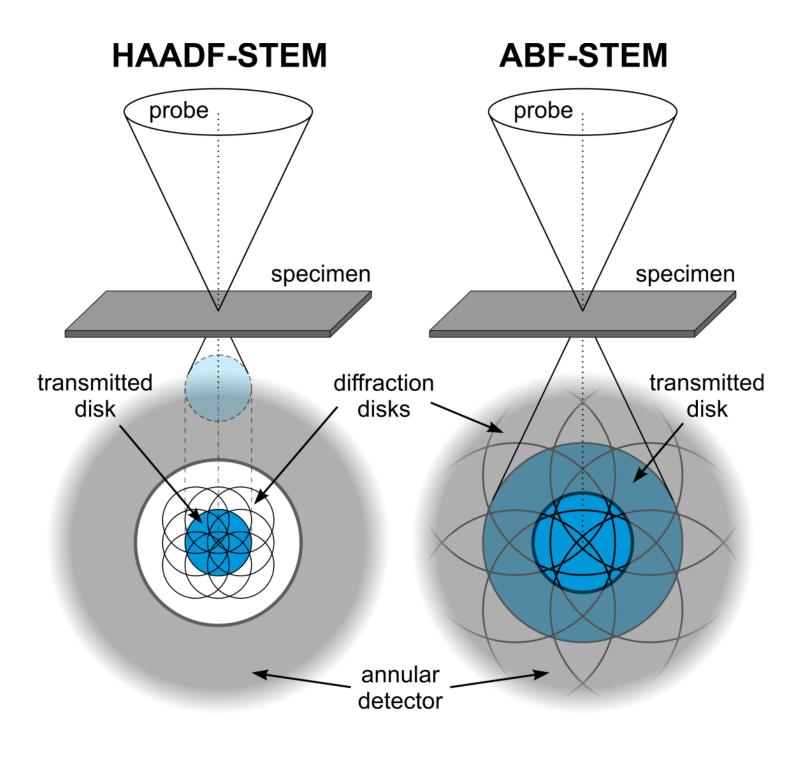
Slice&View: микроструктура интерфейса катод/Ga-LLZO

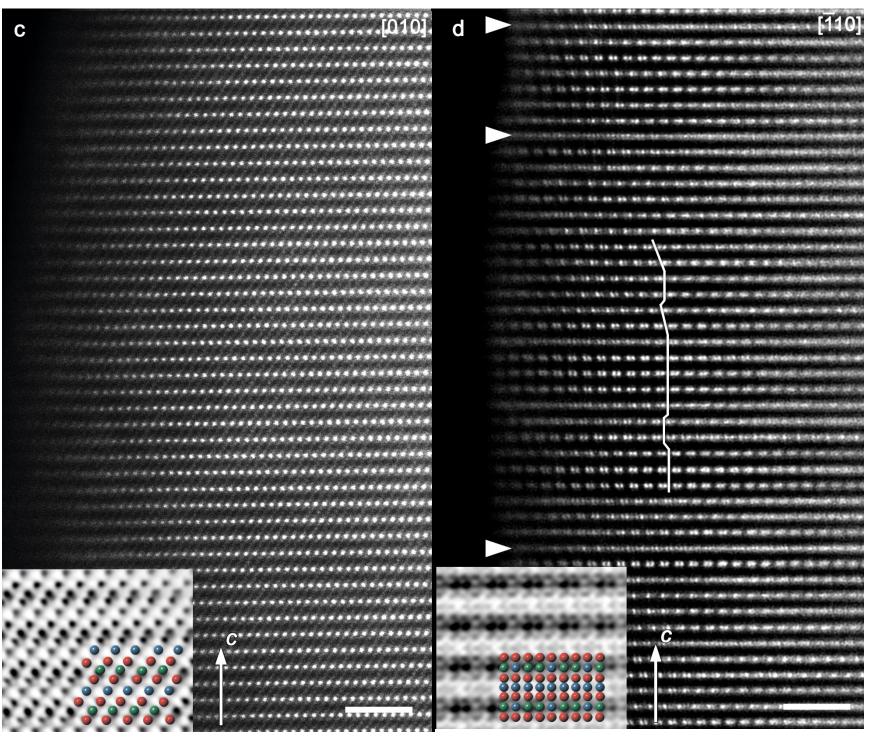
СЭМ изображения в процессе Slice&View и результаты 3D реконструкции слоя вблизи границы катод/электролит





Сканирующая-просвечивающая электронная микроскопия

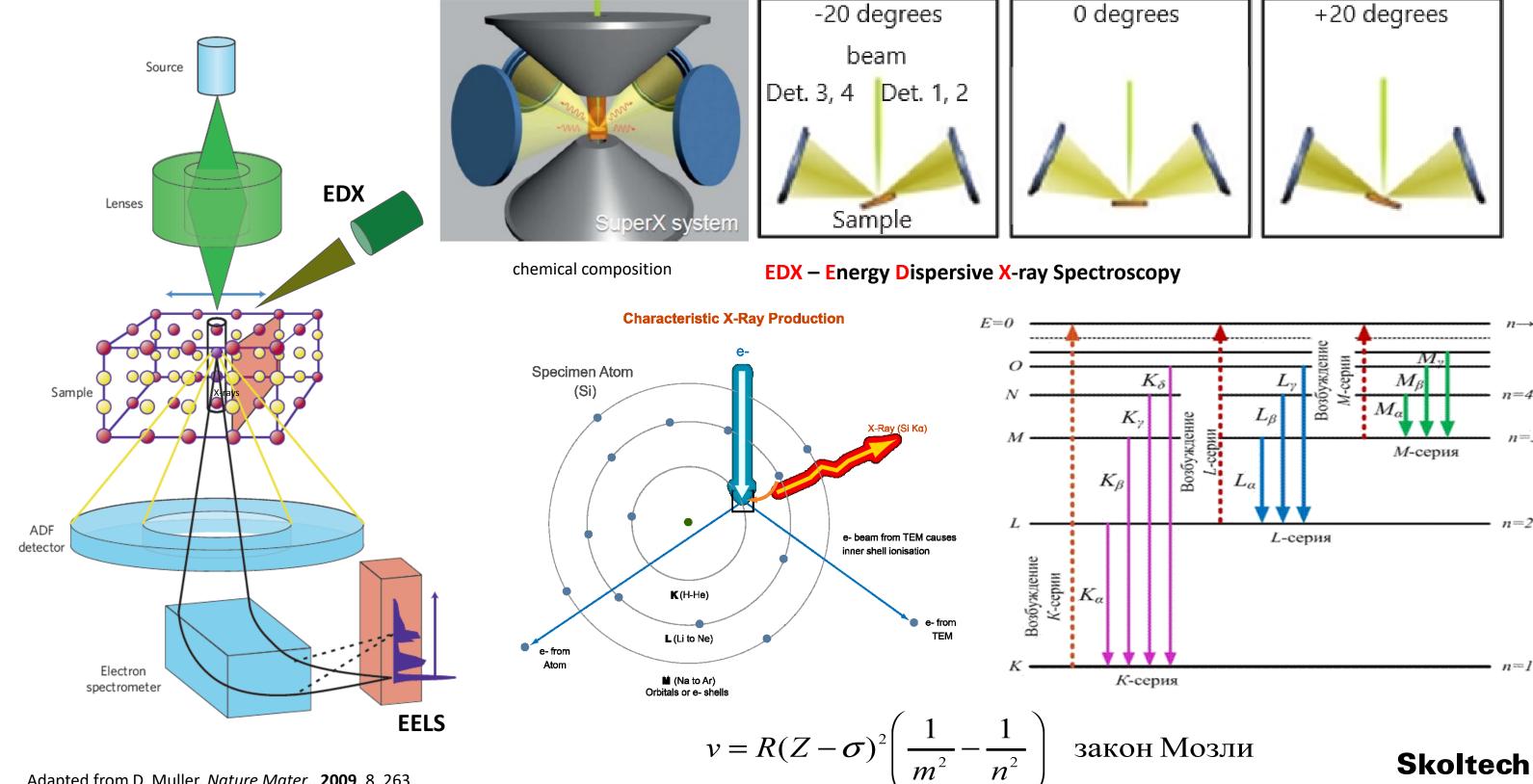




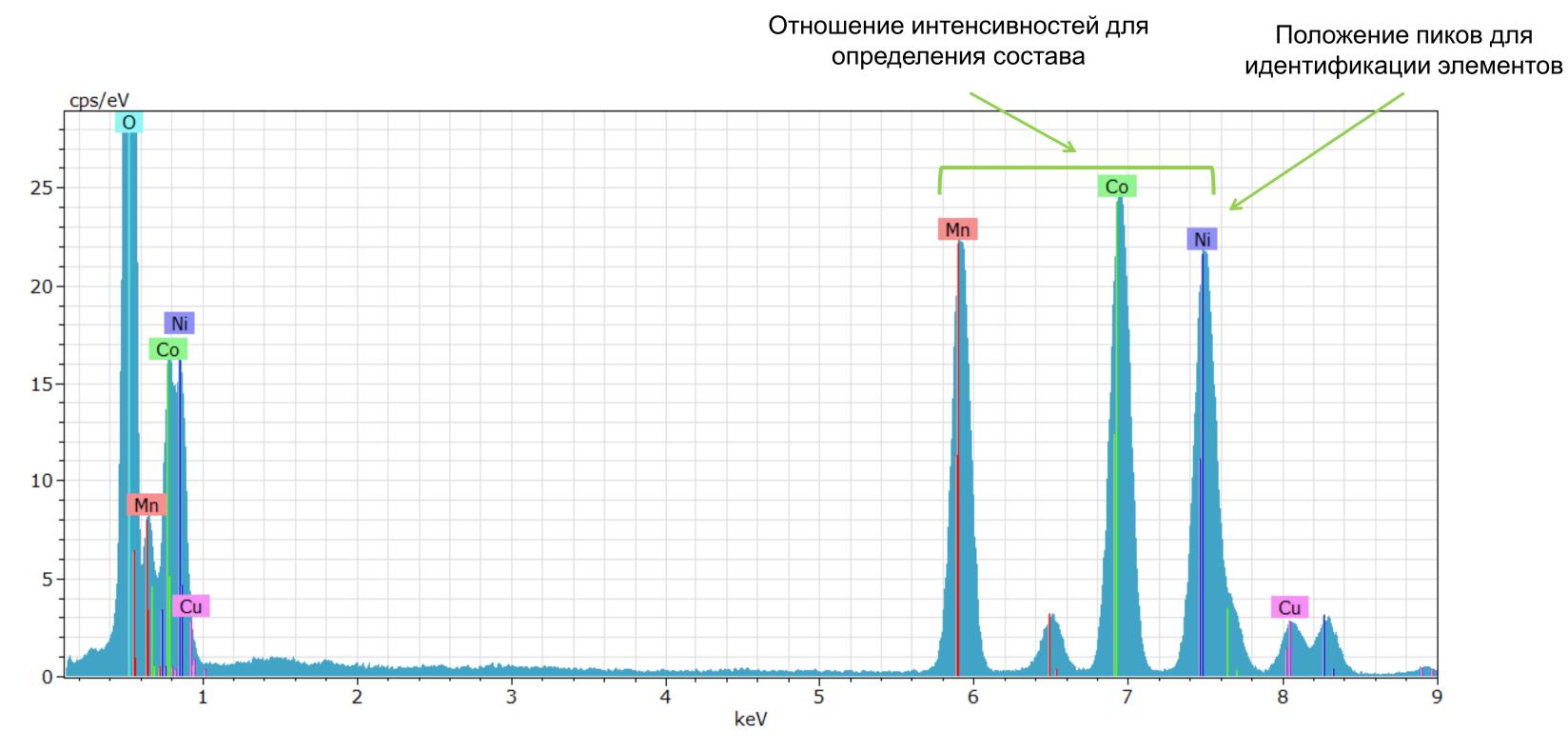
 $I \sim Z^2$

 $I \sim Z^{1/3}$

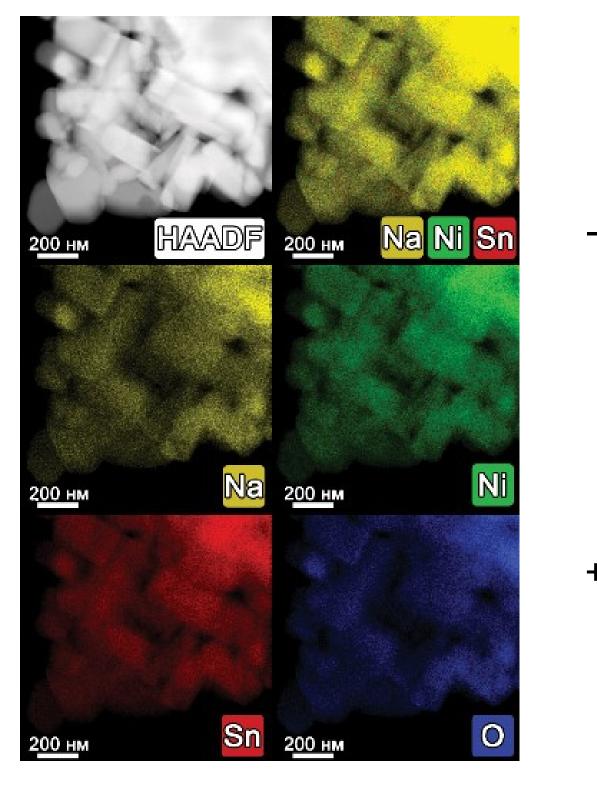
Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия



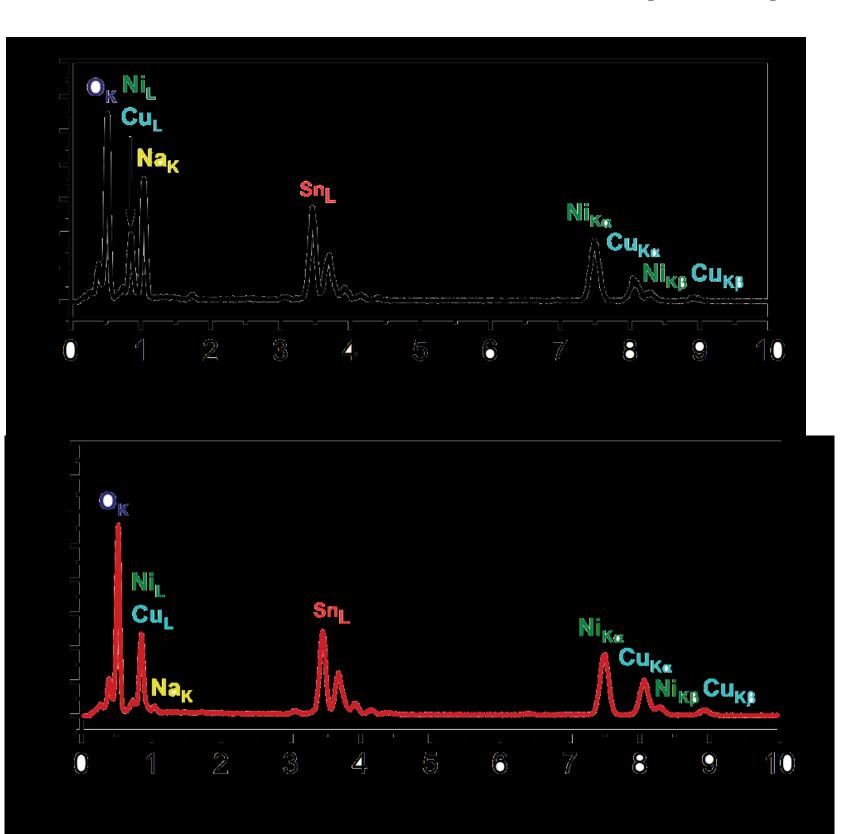
Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС)



Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС)

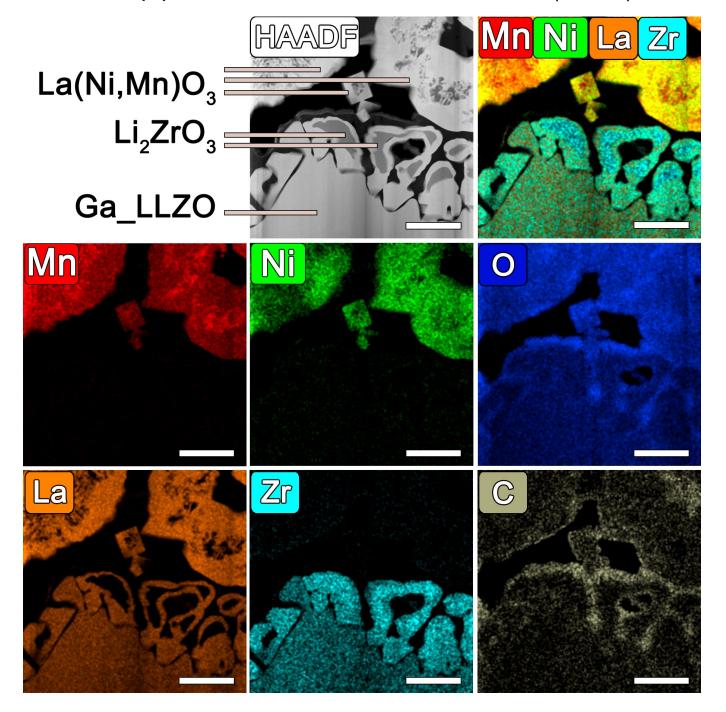




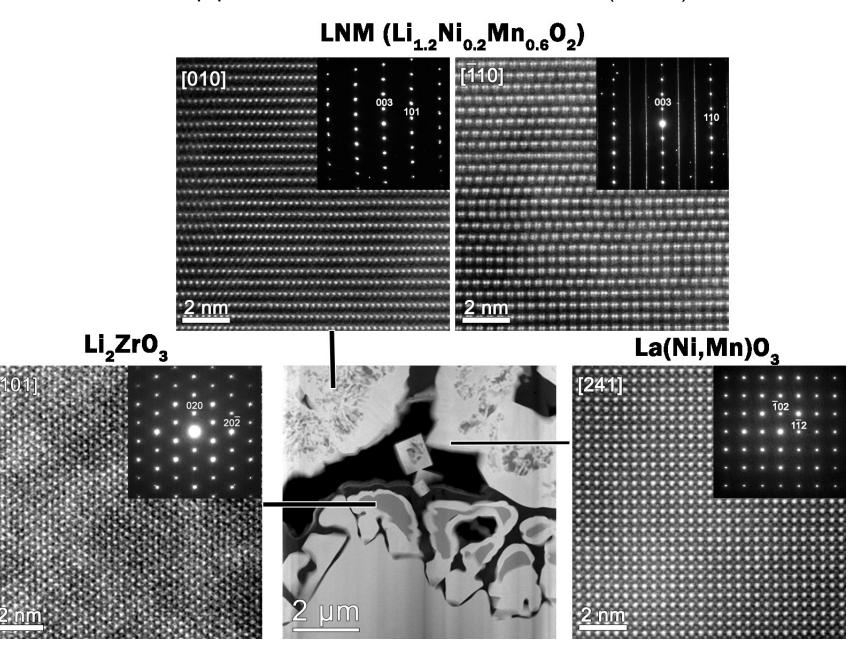


Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС)

СПЭМ-ЭДС карты пространственного распределения элементов на интерфейсе LNM/Ga-LLZO после отжига (900°C)



Изображения темнопольной СПЭМ и ЭД для интерфейса LNM/Ga-LLZO после отжига (900°C)



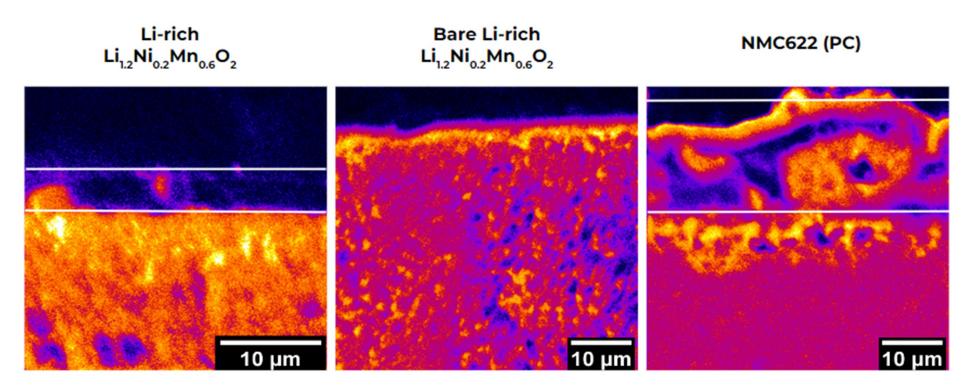
Определение Li

«Объёмный» метод Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)

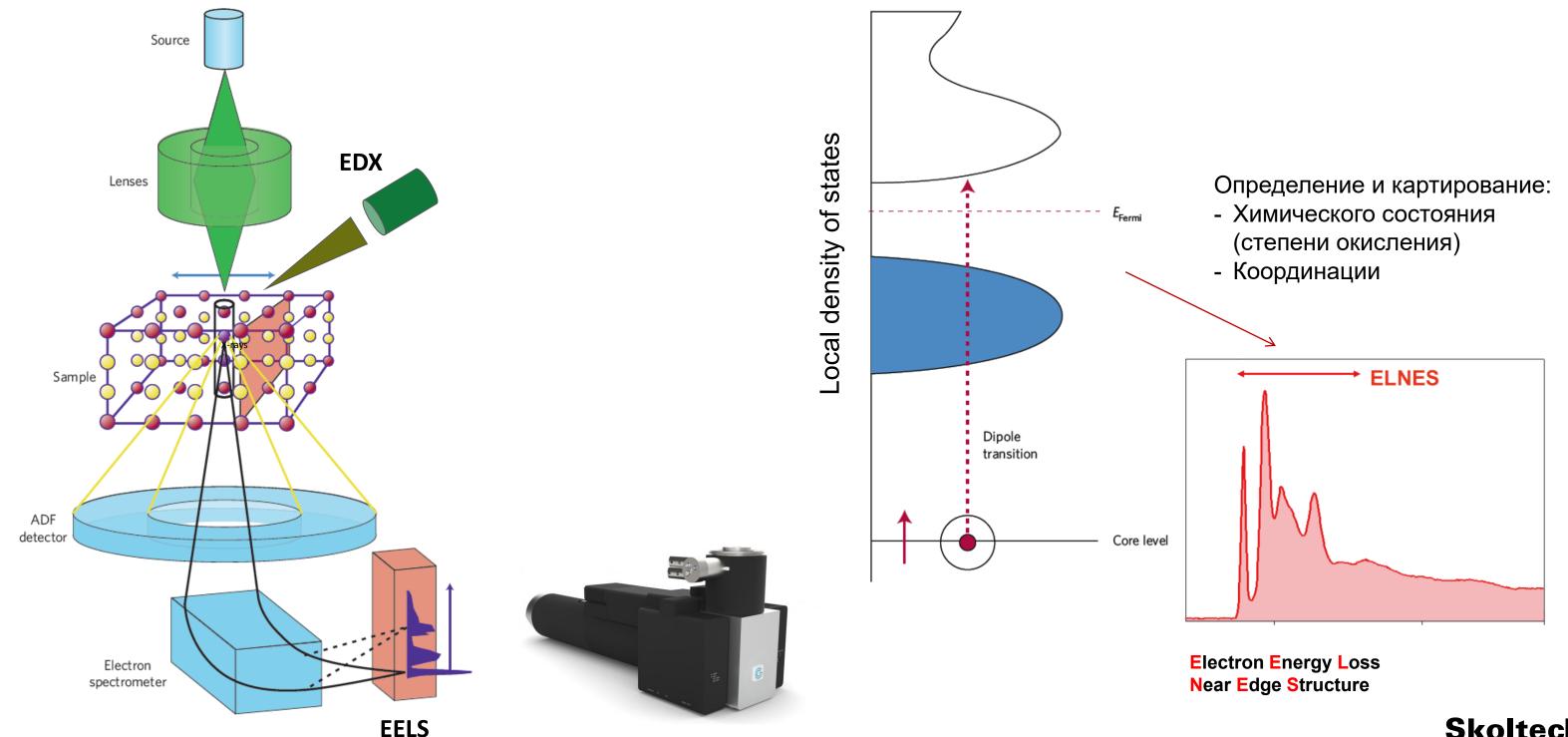
Оптико-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)



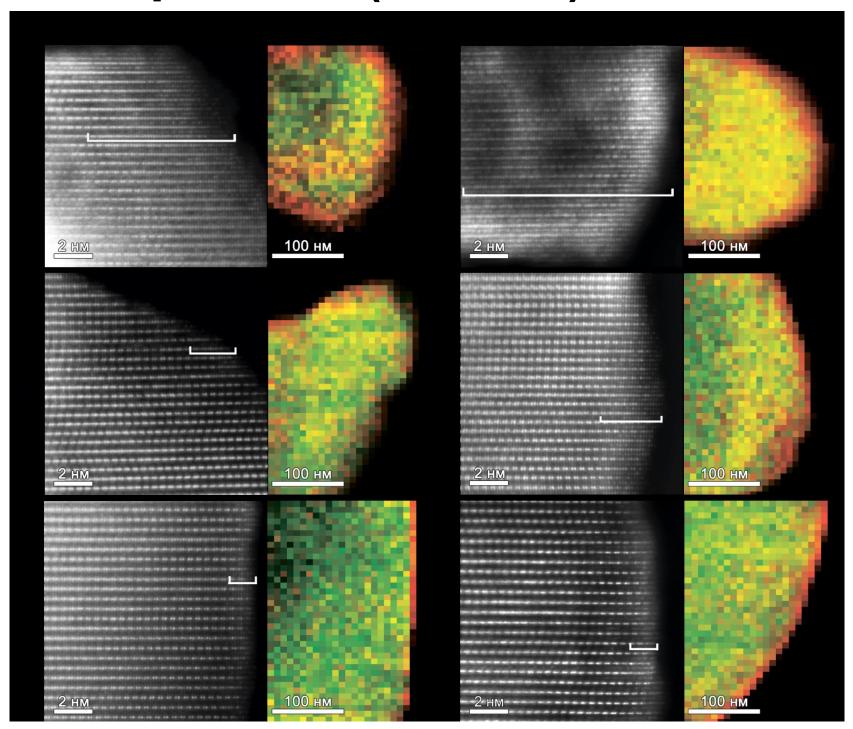
«Локальный» метод Времяпролётная масс-спектрометрия вторичных ионов (TOF-SIMS)



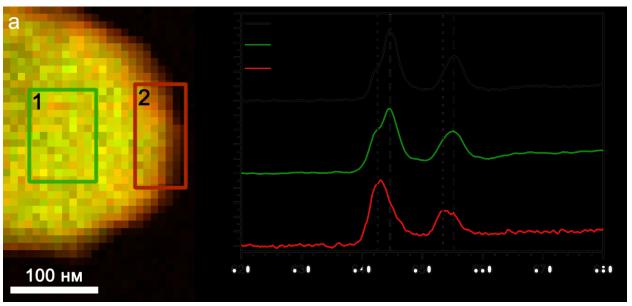
Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ)



Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ)

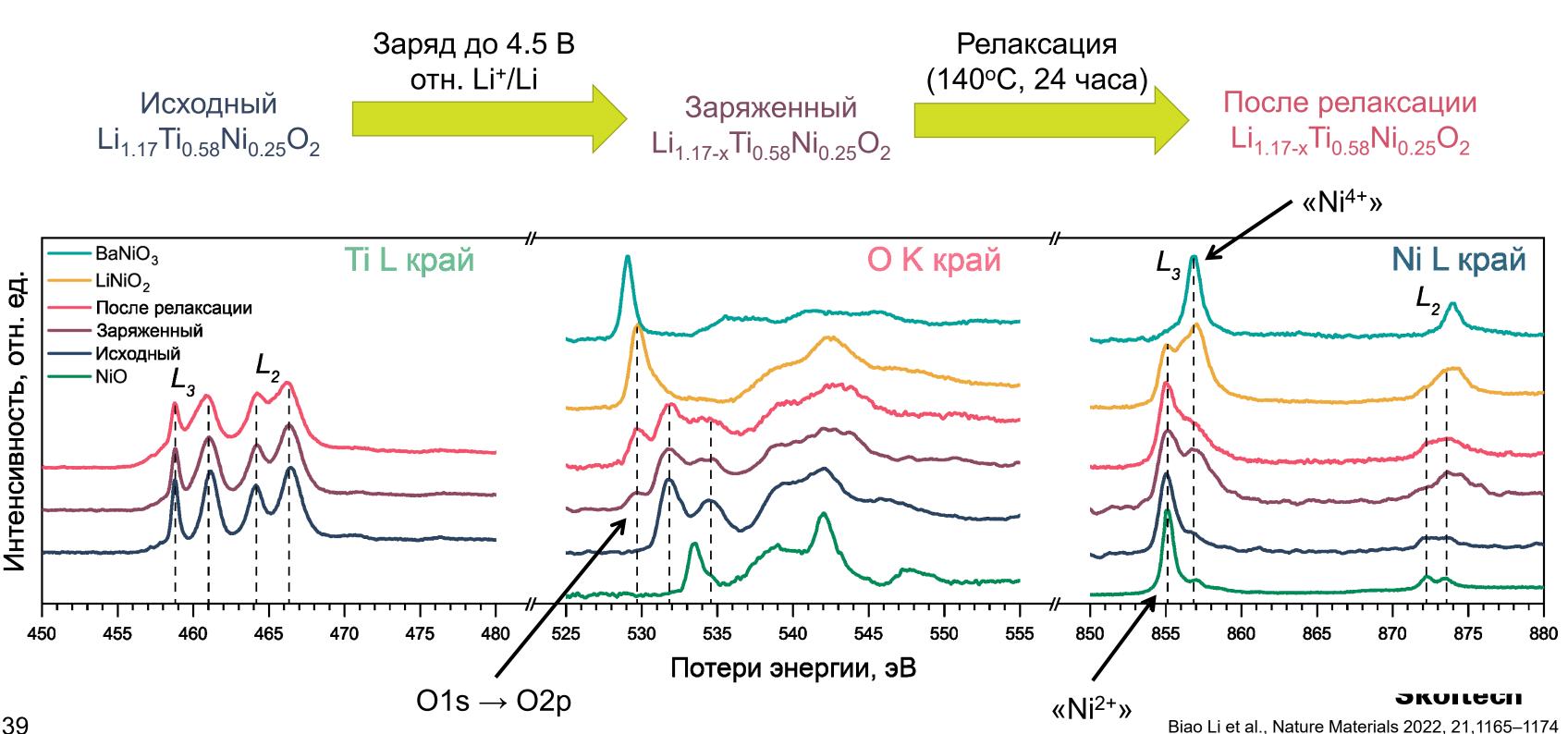


[110] темнопольные СПЭМ изображения высокого разрешения и СПЭМ-СХПЭЭ карты степени окисления Mn

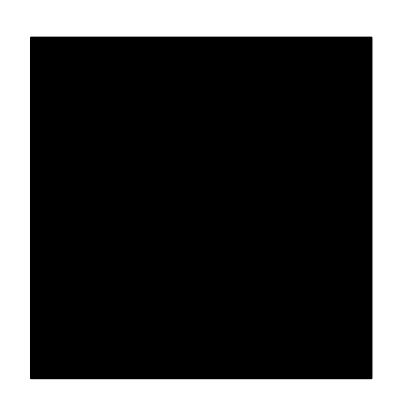


Образец	Степень окисления Mn (после 20 циклов)						
	Объём	Поверхность					
LNM	3.5+	2.8+					
LNMR5	3.6+	3.0+					
LNMR10	3.9+	3.3+					

Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ)



Благодарности





Российский научный фонд

проект № 23-73-30003



Спасибо за внимание